

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-200340
(P2009-200340A)

(43) 公開日 平成21年9月3日(2009.9.3)

| (51) Int.Cl. | F I | テーマコード (参考) |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| HO 1 L 21/8247 (2006.01) | HO 1 L 27/10 4 3 4 | 5 F 0 3 2 |
| HO 1 L 27/115 (2006.01) | HO 1 L 27/10 4 8 1 | 5 F 0 8 3 |
| HO 1 L 27/10 (2006.01) | HO 1 L 29/78 3 7 1 | 5 F 1 0 1 |
| HO 1 L 29/788 (2006.01) | HO 1 L 21/76 L | |
| HO 1 L 29/792 (2006.01) | | |

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 37 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2008-41782 (P2008-41782)
(22) 出願日 平成20年2月22日 (2008.2.22)

(71) 出願人 308014341
富士通マイクロエレクトロニクス株式会社
東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
(74) 代理人 100087479
弁理士 北野 好人
(72) 発明者 小倉 寿典
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内
(72) 発明者 小倉 輝
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内
(72) 発明者 兒嶋 秀之
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

最終頁に続く

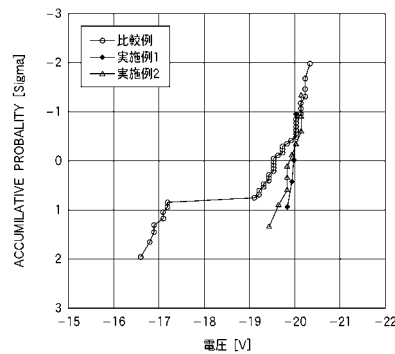
(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置に関し、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧低下を防止しうる半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体基板に活性領域を画定する素子分離領域を形成する工程と、第1の絶縁膜を形成する工程と、第1の絶縁膜とはエッチング特性の異なる第2の絶縁膜を形成する工程と、少なくとも活性領域と素子分離領域との境界を含む領域に形成された第2の絶縁膜を、フルオロカーボン系のエッチングガスを用いたドライエッチングにより除去する工程と、酸素を含む雰囲気曝すことにより、ドライエッチングの際に第1の絶縁膜上に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程と、第1の絶縁膜をウェットエッチングにより除去する工程とを有する。

【選択図】 図3 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体基板の表面に、活性領域を画定する素子分離領域を形成する工程と、
前記素子分離領域が形成された前記半導体基板上に、第 1 の絶縁膜を形成する工程と、
前記第 1 の絶縁膜が形成された前記半導体基板上に、前記第 1 の絶縁膜とはエッチング
特性の異なる第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

少なくとも前記活性領域と前記素子分離領域との境界を含む第 1 の領域に形成された前
記第 2 の絶縁膜を、フルオロカーボン系のエッチングガスを用いたドライエッチングによ
り除去する工程と、

酸素を含む雰囲気曝すことにより、前記ドライエッチングの際に前記第 1 の絶縁膜上
に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程と、

前記第 1 の領域に形成された前記第 1 の絶縁膜を、ウェットエッチングにより除去する
工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、

前記フルオロカーボン膜を除去する工程では、アルゴンガスと酸素ガスとを含む混合ガ
スを用いた反応性イオンエッチングにより、前記フルオロカーボン膜を除去する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の半導体装置の製造方法において、

前記酸素ガスの流量は、プロセスガスの総流量に対して、0.5 ~ 25% である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

請求項 2 又は 3 記載の半導体装置の製造方法において、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と、前記フルオロカーボン膜を除去する工程は、同一
の処理室内で連続して行う

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、

前記フルオロカーボン膜を除去する工程では、 CF_4 ガスと酸素ガスとを含む混合ガス
を用いたケミカルドライエッチングにより、前記フルオロカーボン膜を除去する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 5 記載の半導体装置の製造方法において、

前記 CF_4 ガスの流量は、プロセスガスの総流量に対して、0.05 ~ 10% である

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、

前記素子分離領域を形成する工程の後、前記第 1 の絶縁膜を形成する工程の前に、前記
素子分離領域を構成する第 3 の絶縁膜の上部をエッチングする工程を更に有し、

前記第 1 の絶縁膜の形成の際、前記活性領域と前記素子分離領域との前記境界近傍の前
記素子分離領域に、前記活性領域の表面よりも窪んだ窪みが形成されている

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、

前記第 1 の領域とは異なる第 2 の領域内の活性領域に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2
の絶縁膜を有する不揮発メモリトランジスタを形成する工程を更に有する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 9】

10

20

30

40

50

請求項 8 記載の半導体装置の製造方法において、

前記素子分離領域を形成する工程の後、前記第 1 の絶縁膜を形成する工程の前に、前記第 2 の領域内の前記活性領域上にトンネル絶縁膜を形成する工程と、前記トンネル絶縁膜上に、前記第 2 の領域にフローティングゲートを形成する工程とを、

前記第 1 の絶縁膜を除去する工程の後に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を介して前記フローティングゲート上にコントロールゲートを形成する工程を、更に有し、

前記フローティングゲートと前記コントロールゲートとを有するスタックゲート構造の前記不揮発メモリトランジスタを形成する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 10】

10

請求項 8 記載の半導体装置の製造方法において、

前記第 1 の絶縁膜を除去する工程の後に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を介してコントロールゲートを形成する工程を更に有し、

前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を電荷蓄積層とする単層ゲート構造の前記不揮発メモリトランジスタを形成する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

20

本発明は、半導体装置の製造方法に係り、特に、不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

不揮発性半導体メモリを混載したロジック半導体装置は、CPLD (Complex Programmable Logic Device)、FPGA (Field Programmable Gate Array) といった製品分野を形成し、そのプログラマブルという特徴により大きな市場を形成するに至っている。

【0003】

不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置では、フラッシュメモリセルのほか、フラッシュメモリ制御のための高電圧トランジスタや、高性能ロジック回路のための低電圧トランジスタが、同一半導体チップ上に集積される。ここで、フラッシュメモリセルは、高電圧トランジスタや低電圧トランジスタにおける単層構造のゲート電極とは異なり、フローティングゲートとコントロールゲートとが積層されてなるスタック構造のゲート電極を有する。

30

【0004】

通常、スタックゲート構造からなるフラッシュメモリセルのゲート電極は、フローティングゲートを第 1 層目の導電膜により形成し、コントロールゲートを第 2 層目の導電膜により形成する。単層ゲート構造からなる周辺トランジスタのゲート電極は、第 2 層目の導電膜により形成する。また、フローティングゲートとコントロールゲートとの間には、これら電極間を絶縁して容量結合するためのゲート間絶縁膜が形成されている。このゲート間絶縁膜は、典型的にはシリコン酸化膜とシリコン窒化膜との積層膜 (例えばONO膜) により構成され、周辺トランジスタ領域には形成されない。このため、不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置の製造プロセスでは、第 2 層目の導電膜の堆積前に、周辺トランジスタ形成領域のゲート間絶縁膜を除去する工程が必要である。

40

【0005】

また、不揮発性メモリとしては、上記フラッシュメモリのほか、絶縁膜 (例えば、ONO膜) を電荷蓄積層とした単層ゲート構造の不揮発性メモリが知られている。この不揮発性メモリの場合にも、ゲート電極の形成前に、周辺トランジスタ形成領域の電荷蓄積層を除去する必要がある。不揮発性メモリの制御に用いられる高電圧トランジスタの形成は、上述のフラッシュメモリの場合と同様の製造プロセスにより行われていた。

50

【特許文献1】特開平02-244628号公報

【特許文献2】M. Hayashi et al., "Desorption species from fluorocarbon film by Ar⁺ ion beam bombardment", J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 18, No. 4, Jul/Aug 2000, pp. 1881-1886

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置の製造プロセスについて本願発明者等が検討を行ったところ、上述のプロセスにより製造した半導体装置において、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧が低下する不具合が生じることが判明した。

10

【0007】

本発明の目的は、不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置において、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧低下を防止しうる半導体装置の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の一観点によれば、半導体基板の表面に、活性領域を画定する素子分離領域を形成する工程と、前記素子分離領域が形成された前記半導体基板上に、第1の絶縁膜を形成する工程と、前記第1の絶縁膜が形成された前記半導体基板上に、前記第1の絶縁膜とはエッチング特性の異なる第2の絶縁膜を形成する工程と、少なくとも前記活性領域と前記素子分離領域との境界を含む第1の領域に形成された前記第2の絶縁膜を、フルオロカーボン系のエッチングガスを用いたドライエッチングにより除去する工程と、酸素を含む雰囲気中に曝すことにより、前記ドライエッチングの際に前記第1の絶縁膜上に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程と、前記第1の領域に形成された前記第1の絶縁膜を、ウェットエッチングにより除去する工程とを有する半導体装置の製造方法が提供される。

20

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、不揮発性メモリを混載したロジック半導体装置の製造方法において、周辺回路領域に形成されたゲート間絶縁膜又は電荷蓄積層を除去する過程において、上層部を除去した後、上層部除去の際に表面に付着したフルオロカーボン膜を除去し、その後下層部を除去するので、素子分離膜縁部の窪みの形状が変化することを防止することができる。これにより、素子分離膜端部における電界集中が防止され、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧劣化を防止することができる。これにより、半導体装置の製造歩留まりを向上することができ、ひいては製造コストを削減することができる。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

[第1実施形態]

本発明の第1実施形態による半導体装置の製造方法について図1乃至図31を用いて説明する。

40

【0011】

図1は本実施形態による半導体装置の構造を示す平面図、図2は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図3乃至図28は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図、図29はONO膜の除去過程におけるフルオロカーボン膜の影響を説明する図、図30はフルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料と行った試料とにおける素子分離膜端部の断面形状を示すTEM像、図31は高電圧トランジスタのゲート電極に逆バイアスを印加したときのゲート絶縁膜耐圧を示すグラフである。

【0012】

はじめに、本実施形態による半導体装置の構造について図1及び図2を用いて説明する。図2(a)は図1のA-A線に沿った概略断面図であり、図2(b)は図1のB-B

50

線に沿った概略断面図である。

【0013】

本実施形態による半導体装置は、スタックゲート構造の不揮発メモリトランジスタを混載したロジック半導体装置である。図1に示すように、不揮発メモリトランジスタ（Flash）がマトリクス状に形成されたメモリセル領域と、論理回路を構成するロジックトランジスタや不揮発メモリトランジスタの駆動用の高耐圧トランジスタなどの種々の周辺トランジスタが形成された周辺回路領域を有している。本実施形態では、周辺トランジスタとして、高速ロジック回路を構成する低電圧トランジスタ（LV-Tr）と、入出力回路を構成する中電圧トランジスタ（MV-Tr）と、不揮発メモリトランジスタを制御するための高電圧トランジスタ（HV-Tr）を有しているものとする。

10

【0014】

不揮発メモリトランジスタ（Flash）は、図1及び図2に示すように、シリコン基板10上にトンネル絶縁膜34を介して形成されたフローティングゲート68と、フローティングゲート68上にONO膜42を介して形成され、ワード線を兼ねるコントロールゲート70と、コントロールゲート70の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域98とを有している。

【0015】

低電圧トランジスタ（LV-Tr）は、図1及び図2に示すように、シリコン基板10上にゲート絶縁膜54を介して形成されたゲート電極84と、ゲート電極84の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有している。

20

【0016】

中電圧トランジスタ（MV-Tr）は、図1及び図2に示すように、シリコン基板10上にゲート絶縁膜56を介して形成されたゲート電極84と、ゲート電極84の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有している。

【0017】

高電圧トランジスタ（HV-Tr）は、図1及び図2に示すように、シリコン基板10上にゲート絶縁膜58を介して形成されたゲート電極84と、ゲート電極84の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有している。

【0018】

周辺トランジスタのゲート絶縁膜は、各トランジスタの耐圧に応じて、ゲート絶縁膜54、ゲート絶縁膜56、ゲート絶縁膜58の順に厚くなっている。

30

【0019】

なお、本実施形態では、低電圧トランジスタ（LV-Tr）、中電圧トランジスタ（MV-Tr）及び高電圧トランジスタ（HV-Tr）をそれぞれ1つずつしか示していないが、実際には、それぞれに導電型の異なるN型及びP型のトランジスタが含まれる。また、閾値電圧の異なる複数のトランジスタを用いることもある。

【0020】

次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図3乃至図28を用いて説明する。各図面において、(a)は周辺回路領域の工程断面図（図1のA-A線断面に相当）であり、(b)はメモリセル領域の工程断面図（図2のB-B線断面に相当）である。

40

【0021】

まず、例えば熱酸化法により、シリコン基板10の表面を熱酸化し、例えば膜厚8~16nm程度のシリコン酸化膜12を形成する。

【0022】

次いで、シリコン酸化膜12上に、例えば700~900の温度の熱CVD（Chemical Vapor Deposition）法により、例えば膜厚55~130nmのシリコン窒化膜14を形成する。

【0023】

次いで、シリコン窒化膜14上に、例えば550~680の温度の熱CVD法により

50

、例えば膜厚 60 ~ 120 nm のポリシリコン膜 16 を形成する。

【0024】

次いで、ポリシリコン膜 16 上に、スピコート法により、BARC (Bottom Anti-Reflective Coating) 膜 18 とフォトレジスト膜 20 とを形成する。

【0025】

次いで、フォトリソグラフィにより、フォトレジスト膜 20 に、素子分離膜の形成予定領域を露出する開口部を形成する (図 3 (a)、図 3 (b))。

【0026】

次いで、フォトレジスト膜 20 をマスクとして、ドライエッチングにより、BARC 膜 18、ポリシリコン膜 16 及びシリコン窒化膜 14 をパターニングし、フォトレジスト膜 20 のパターンをポリシリコン膜 16 及びシリコン窒化膜 14 に転写する (図 4 (a)、図 4 (b))。

10

【0027】

なお、ポリシリコン膜 16 は、シリコン窒化膜 14 をパターニングする際にハードマスクとして用いる膜である。シリコン窒化膜 14 のパターニングをフォトレジスト膜 20 だけで十分に行える場合には、必ずしもポリシリコン膜 16 を形成する必要はない。

【0028】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、ポリシリコン膜 16 上に残存する BARC 膜 18 及びフォトレジスト膜 20 を除去する (図 5 (a)、図 5 (b))。

【0029】

次いで、パターニングしたポリシリコン膜 16 及びシリコン窒化膜 14 をマスクとして、シリコン酸化膜 12 及びシリコン基板 10 をエッチングし、シリコン基板 10 に、素子分離用のトレンチ 22 を形成する (図 6 (a)、図 6 (b))。なお、ポリシリコン膜 16 は、シリコン基板 10 のエッチングとともに除去される。

20

【0030】

次いで、必要に応じて適切な後処理を行い、半導体基板 10 の表面に付着したエッチングによる副生成物を除去する。

【0031】

次いで、例えば熱酸化法により、シリコン窒化膜 14 をマスクとしてシリコン基板 10 を熱酸化し、トレンチ 22 の内面に、例えば膜厚 1 ~ 18 nm のシリコン酸化膜 24 を形成する。

30

【0032】

次いで、全面に、例えば 250 ~ 600 の温度の HDP (High Density Plasma) CVD 法により、例えば膜厚 250 ~ 750 nm のシリコン酸化膜 26 を形成する (図 7 (a)、図 7 (b))。これにより、トレンチ 22 内はシリコン酸化膜 26 によって完全に埋め込まれる。

【0033】

次いで、CMP (Chemical Mechanical Polishing) 法により、シリコン窒化膜 14 の表面が露出するまでシリコン酸化膜 26 の表面を研磨し、表面を平坦化する。これにより、シリコン酸化膜 24、26 よりなる素子分離膜 28 を形成する (図 8 (a)、図 8 (b))。これにより、シリコン基板 10 の表面には、素子分離膜 28 により画定された複数の活性領域が形成される。

40

【0034】

次いで、適切な後処理により、CMP のスラリーを除去する。

【0035】

次いで、窒素雰囲気中で、例えば 800 ~ 1100 の温度で熱処理を行う。

【0036】

次いで、全面に、スピコート法によりフォトレジスト膜 30 を形成した後、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 30 パターニングする。これにより、周辺回路領域を覆いメモリセル領域を露出するフォトレジスト膜 30 を形成する。

50

【 0 0 3 7 】

次いで、フォトレジスト膜 30 をマスクとして、例えば弗酸水溶液を用いたウェットエッチングにより、素子分離膜 28 の上面を例えば 10 ~ 80 nm 程度エッチングする (図 9 (a)、図 9 (b))。

【 0 0 3 8 】

次いで、例えば純水により 10 : 1 ~ 200 : 1 程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、シリコン窒化膜 14 上の自然酸化膜 (図示せず) を除去する。

【 0 0 3 9 】

次いで、例えば 130 の燐酸水溶液によりウェットエッチングを行い、シリコン窒化膜 14 を除去する。

【 0 0 4 0 】

次いで、例えば弗酸水溶液を用いたウェットエッチングにより、シリコン酸化膜 12 を除去する。

【 0 0 4 1 】

次いで、例えば熱酸化法により、シリコン基板 10 の表面に、例えば膜厚 8 ~ 16 nm のシリコン酸化膜を形成する。これにより、シリコン酸化膜よりなるイオン注入用の犠牲酸化膜 32 を形成する (図 10 (a)、図 10 (b))。

【 0 0 4 2 】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、メモリセル領域及び高電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル (図示せず) を形成する。例えば、メモリセル領域及び N 型高電圧トランジスタ形成領域には N 型ウェル内に P 型ウェルが形成された二重ウェルを形成し、P 型高電圧トランジスタ形成領域には N 型ウェルを形成する。N 型ウェルは、例えば燐イオンを、加速エネルギーを例えば 300 ~ 500 keV、ドーズ量を例えば $1 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ の条件でイオン注入することにより形成する。P 型ウェルは、例えばボロンイオンを、加速エネルギーを例えば 100 ~ 350 keV、ドーズ量を例えば $1 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ の条件でイオン注入することにより形成する。二重ウェルの底部の N 型埋め込み層は、例えば燐イオンを、加速エネルギーを例えば 1.6 ~ 2.6 MeV、ドーズ量を例えば $2 \times 10^{11} \sim 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ の条件でイオン注入することにより形成する。

【 0 0 4 3 】

次いで、窒素雰囲気中で、例えば 900 ~ 1200 の温度で 1 ~ 15 秒間の熱処理を行い、注入した不純物を活性化する。

【 0 0 4 4 】

次いで、例えば純水により 10 : 1 ~ 200 : 1 程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、犠牲酸化膜 32 を除去する。

【 0 0 4 5 】

なお、素子分離膜 28 は、シリコン酸化膜 12 や犠牲酸化膜 32 の除去工程などにおいて徐々に膜減りする。これにより、犠牲酸化膜 32 を除去した後は、素子分離膜 28 と活性領域との境目に、活性領域表面より窪んだ窪みが形成されている。

【 0 0 4 6 】

次いで、シリコン基板 10 の表面に、例えば膜厚 3 ~ 15 nm のシリコン酸化膜よりなるトンネル絶縁膜 34 を形成する (図 11 (a)、図 11 (b))。トンネル絶縁膜 34 は、例えば 300 ~ 550 の温度でのラジカル酸化、例えば 850 ~ 1100 の温度での熱酸化等により形成する。

【 0 0 4 7 】

次いで、全面に、例えば CVD 法により、例えば膜厚が 50 ~ 100 nm であり、例えば $0.2 \sim 10 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ の濃度で燐を含有したアモルファスシリコン膜 36 を形成する (図 12 (a)、図 12 (b))。アモルファスシリコン膜 36 は、フローティングゲートとなる膜である。

【 0 0 4 8 】

10

20

30

40

50

次いで、アモルファスシリコン膜 36 上に、スピコート法により、BARC (Bottom Anti-Reflective Coating) 膜 38 とフォトレジスト膜 40 とを形成する。

【0049】

次いで、フォトリソグラフィにより、フォトレジスト膜 40 に、周辺回路領域と、メモリセル領域内の所定領域を露出する開口部を形成する(図 13 (a)、図 13 (b))。メモリセル領域内の所定領域は、ワード線(コントロールゲート)の形成領域と素子分離領域とが重なる領域であり、ワード線の延在方向にフローティングゲートを分離するための領域に相当する。

【0050】

次いで、フォトレジスト膜 40 をマスクとして、例えば誘導結合型プラズマエッチング装置を用いた異方性エッチングにより、アモルファスシリコン膜 36 をパターンニングする(図 14 (a)、図 14 (b))。

【0051】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、アモルファスシリコン膜 36 上に残存する BARC 膜 38 及びフォトレジスト膜 40 を除去する。

【0052】

次いで、全面に、シリコン酸化膜/シリコン窒化膜/シリコン酸化膜の積層構造よりなる ONO 膜 42 を形成する(図 15 (a)、図 15 (b))。ONO 膜 42 は、フローティングゲートとコントロールゲートとを絶縁し容量結合するための膜である。ONO 膜 42 は、例えば 500 ~ 900 の温度の熱 CVD 法により例えば膜厚 3 ~ 5 nm のシリコン酸化膜(ボトム酸化膜)を形成し、例えば 300 ~ 900 の温度の熱 CVD 法により例えば膜厚 5 ~ 10 nm のシリコン窒化膜を形成した後、例えば 800 ~ 1100 の温度の熱酸化によりシリコン窒化膜を 3 ~ 8 nm 程度酸化してシリコン酸化膜(トップ酸化膜)を形成することにより、形成する。

【0053】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル(図示せず)を形成する。例えば、N 型低電圧トランジスタ形成領域及び N 型中電圧トランジスタ形成領域に P 型ウェルを形成し、P 型低電圧トランジスタ形成領域及び P 型中電圧トランジスタ形成領域に N 型ウェルを形成する。

【0054】

次いで、全面に、スピコート法によりフォトレジスト膜 44 を形成した後、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 44 をパターンニングする。これにより、周辺回路領域を露出しメモリセル領域を覆うフォトレジスト膜 44 を形成する。

【0055】

次いで、フォトレジスト膜 44 をマスクとして、例えばマグネトロン反応性イオンエッチング(RIE)装置を用いたドライエッチングにより、ONO 膜 42 のトップ酸化膜及び中間層のシリコン窒化膜をエッチングする。

【0056】

ONO 膜 42 を形成する各々の膜厚は、10 nm 以下と極めて薄い。また、活性領域と素子分離膜との境目には窪みが形成されているため、窪み(傾斜部)に形成された膜を除去するために、オーバーエッチング量を程度 300 % 以上に増加する必要がある。このため、ONO 膜 42 の各々の膜をエッチングする際には、下地に対する選択比を十分に確保する必要がある。

【0057】

かかる観点から、トップ酸化膜のエッチングには、例えばエッチングガスに C_4F_8 、 C_4F_6 、Ar、 O_2 のいずれかの組み合わせとなる混合ガスを用い、下地のシリコン窒化膜に対して選択比が 6.0 程度以上となる条件を用いる。また、中間層のシリコン窒化膜のエッチングには、 CH_3F 、Ar、 O_2 のいずれかの組み合わせとなる混合ガスを用い、下地のボトム酸化膜に対して選択比が 9.0 程度以上となる条件を用いる。

10

20

30

40

50

【 0 0 5 8 】

フルオロカーボン系のエッチングガスを用いた上記エッチング条件では、エッチングに伴い、副生成物であるフルオロカーボン膜が、基板の表面に付着する。

【 0 0 5 9 】

次いで、基板の表面に付着したフルオロカーボン膜を、以下のいずれかの方法で除去する。

【 0 0 6 0 】

第1の方法は、マグネトロンR I E装置を用い、アルゴンガスと酸素ガスとの混合ガスのプラズマに基板を曝すことにより、フルオロカーボン膜を除去する方法である。エッチングの副生成物であるフルオロカーボンにアルゴンビームを照射すると、フッ素が抜けてカーボンリッチの膜となる。この膜に酸素が作用することで、フルオロカーボン膜を除去することができる。この方法は、ONO膜42のトップ酸化膜及びシリコン窒化膜のエッチングに引き続き、同一装置内で処理を行うことができるというメリットがある。

10

【 0 0 6 1 】

具体的な条件としては、例えば、RFパワーが100～300W、圧力が40～100MTorr、プロセスガスの総流量が100～600sccm、ガスの混合比Ar：O₂が100：1～100：15、電極温度が50、処理時間が10～60秒である。

【 0 0 6 2 】

なお、酸素ガスの添加量は、プロセスガスの総流量に対して、0.5%～25%の範囲、好ましくは0.5%～10%程度の範囲に設定することが望ましい。酸素の添加量が0.5%よりも低いとフルオロカーボン膜の除去効果が十分に得られず、酸素の添加量が25%を超えるとフォトレジスト膜44のアッシングが顕著となるからである。フォトレジスト膜44は、後述のボトム酸化膜を除去する際のウェットエッチング工程でもマスク膜として用いるため、フルオロカーボン膜の除去後もウェットエッチングに耐えうる膜厚が残っている必要がある。

20

【 0 0 6 3 】

第2の方法は、ダウンフローエッチング装置を用い、酸素ガス、CF₄ガス及びフォーミングガス（水素3%と窒素97%の混合ガス。以下、「FG」とも表現する。）の混合ガスを用いたケミカルドライエッチングにより、フルオロカーボン膜を除去する方法である。CF₄ガスは、フルオロカーボン膜に対する酸素ラジカルの反応性を高め、フルオロカーボン膜のエッチングを促進する役割を担うものである。また、フォーミングガスは、酸素ラジカルの寿命を長くする役割を担うものである。

30

【 0 0 6 4 】

具体的な条件としては、例えば、マイクロ波パワーが800～1100W、圧力が150～300Pa、プロセスガスの総流量が1200～2000sccm、ガスの混合比O₂：CF₄：FGが617：374：1～61：38：1、処理時間が10～33秒である。

【 0 0 6 5 】

なお、CF₄ガスの添加量は、プロセスガスの総流量に対して、0.05%～3%の範囲、好ましくは0.1%～1%程度に設定することが望ましい。CF₄ガスの添加量が0.05%よりも低いと酸素ラジカルの反応性が低すぎてフルオロカーボン膜の除去効果が十分に得られず、CF₄ガスの添加量3%を超えると酸素ラジカルの反応性が高くなりすぎフォトレジスト膜44のアッシングが顕著となるからである。

40

【 0 0 6 6 】

フルオロカーボン膜を除去する工程の目的及び効果については、後述する。

【 0 0 6 7 】

次いで、フォトレジスト膜44をマスクとして、例えば純水により100：1～200：1程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、ONO膜42のボトム酸化膜及びトンネル絶縁膜34を除去する（図16（a）、図16（b））。

【 0 0 6 8 】

50

次いで、アッシング及びその後の後処理により、フォトレジスト膜 44 を除去する。

【0069】

次いで、例えば熱酸化法により、周辺回路領域のシリコン基板 10 の表面に、例えば膜厚 3 ~ 20 nm のシリコン酸化膜 46 を形成する（図 17 (a)、図 17 (b)）。

【0070】

次いで、全面に、スピコート法によりフォトレジスト膜 48 を形成した後、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 48 パターニングする。これにより、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域を露出し、高電圧トランジスタ形成領域及びメモリセル領域を覆うフォトレジスト膜 48 を形成する。

【0071】

次いで、フォトレジスト膜 48 をマスクとして、例えば純水により 100 : 1 ~ 200 : 1 程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域のシリコン酸化膜 46 を選択的に除去する（図 18 (a)、図 18 (b)）。

【0072】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、フォトレジスト膜 48 を除去する。

【0073】

次いで、シリコン基板 10 を熱酸化し、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域に、例えば膜厚 1 ~ 12 nm のシリコン酸化膜 50 を形成する（図 19 (a)、図 19 (b)）。この際、シリコン酸化膜 46 は、追加酸化されて膜厚が増加する。

【0074】

次いで、全面に、スピコート法によりフォトレジスト膜 52 を形成した後、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 52 パターニングする。これにより、低電圧トランジスタ形成領域を露出し、中電圧トランジスタ形成領域、高電圧トランジスタ形成領域及びメモリセル領域を覆うフォトレジスト膜 52 を形成する。

【0075】

次いで、フォトレジスト膜 52 をマスクとして、例えば純水により 100 : 1 ~ 200 : 1 程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、低電圧トランジスタ形成領域のシリコン酸化膜 50 を選択的に除去する（図 20 (a)、図 20 (b)）。

【0076】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、フォトレジスト膜 52 を除去する。

【0077】

次いで、シリコン基板 10 を熱酸化し、低電圧トランジスタ形成領域に、例えば膜厚 1 ~ 3 nm のシリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜 54 を形成する。この際、中電圧トランジスタ形成領域では、シリコン酸化膜 50 が追加酸化され、例えば膜厚 2 ~ 15 nm のシリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜 56 が形成される。また、高電圧トランジスタ形成領域では、シリコン酸化膜 46 が更に追加酸化され、例えば膜厚 5 ~ 35 nm のシリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜 58 が形成される。こうして、低電圧トランジスタ形成領域、中電圧トランジスタ形成領域及び高電圧トランジスタ形成領域に、互いに膜厚の異なる 3 種類のゲート絶縁膜 52, 54, 56 を形成する（図 21 (a)、図 21 (b)）。

【0078】

次いで、全面に、例えば CVD 法により、例えば膜厚 50 ~ 110 nm のポリシリコン膜 60 を形成する。

【0079】

次いで、ポリシリコン膜 60 上に、例えば CVD 法により、例えば最表面に 3 nm 以下の酸化膜が形成された膜厚 10 ~ 40 nm のシリコン窒化膜 62 を形成する。

【0080】

次いで、シリコン窒化膜 62 上に、スピコート法により、BARC 膜 64 とフォトレジスト膜 66 とを形成する。

10

20

30

40

50

【 0 0 8 1 】

次いで、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 6 6 をパターンニングし、周辺回路領域及びメモリセル領域のコントロールゲート形成領域を覆うフォトレジスト膜 6 6 を形成する（図 2 2 (a)、図 2 2 (b)）。

【 0 0 8 2 】

次いで、フォトレジスト膜 6 6 をマスクとして、例えば誘導結合型プラズマエッチング装置を用いた異方性エッチングにより、BARC 膜 6 4、シリコン窒化膜 6 2、ポリシリコン膜 6 0、ONO 膜 4 2 及びアモルファスシリコン膜 3 6 をパターンニングし、メモリセル領域に、アモルファスシリコン膜 3 6 よりなるフローティングゲート 6 8 と、ポリシリコン膜 6 0 よりなるコントロールゲート 7 0 とを形成する。

10

【 0 0 8 3 】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、シリコン窒化膜 6 2 上に残存する BARC 膜 6 4 及びフォトレジスト膜 6 6 を除去する（図 2 3 (a)、図 2 3 (b)）。

【 0 0 8 4 】

次いで、熱酸化法により、フローティングゲート 6 8 及びコントロールゲート 7 0 の側壁部分に、シリコン酸化膜よりなる側壁絶縁膜 7 2 を形成する。

【 0 0 8 5 】

次いで、コントロールゲート 7 0 をマスクとしてイオン注入を行い、コントロールゲート 7 0 の両側のシリコン基板 1 0 内に、不純物拡散領域 7 4 を形成する。

【 0 0 8 6 】

次いで、全面に、例えば熱 CVD 法により、例えば膜厚 3 0 ~ 1 5 0 nm のシリコン窒化膜 7 6 を形成する（図 2 4 (a)、図 2 4 (b)）。

20

【 0 0 8 7 】

次いで、ドライエッチングにより、ポリシリコン膜 6 0 及びコントロールゲート 7 0 の上面が露出するまでシリコン窒化膜 7 6、6 2 を異方性エッチングし、側壁絶縁膜 7 2 が形成されたフローティングゲート 6 8 及びコントロールゲート 7 0 の側壁部分に、シリコン窒化膜 7 6 よりなる側壁絶縁膜 7 8 を形成する（図 2 5 (a)、図 2 5 (b)）。

【 0 0 8 8 】

次いで、全面に、例えば熱 CVD 法により、例えば膜厚 1 5 ~ 4 0 nm のシリコン酸化膜 8 0 を形成する。シリコン酸化膜 8 0 は、後工程でポリシリコン膜 6 0 のパターンニングの際にハードマスクとして用いる膜である。

30

【 0 0 8 9 】

次いで、シリコン酸化膜 8 0 上に、スピコート法により、BARC 膜 8 2 とフォトレジスト膜 8 4 とを形成する。

【 0 0 9 0 】

次いで、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜 8 4 をパターンニングし、メモリセル領域及び周辺トランジスタ（低電圧トランジスタ、中電圧トランジスタ及び高電圧トランジスタ）のゲート電極形成領域を覆うフォトレジスト膜 8 4 を形成する（図 2 6 (a)、図 2 6 (b)）。

【 0 0 9 1 】

次いで、フォトレジスト膜 8 4 をマスクとして、例えば誘導結合型プラズマエッチング装置を用いた異方性エッチングにより、BARC 膜 8 2、シリコン酸化膜 8 0 及びポリシリコン膜 6 0 をパターンニングし、周辺回路領域に、ポリシリコン膜 6 0 よりなるゲート電極 8 6 を形成する。

40

【 0 0 9 2 】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、シリコン酸化膜 8 0 上に残存する BARC 膜 8 2 及びフォトレジスト膜 8 4 を除去する。

【 0 0 9 3 】

次いで、例えば弗酸水溶液を用いたウェットエッチングにより、シリコン酸化膜 8 0 を除去する。

50

【0094】

次いで、ゲート電極86をマスクとしてイオン注入を行い、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に、不純物拡散領域88を形成する(図27(a)、図27(b))。

【0095】

次いで、例えば熱CVD法により例えばシリコン窒化膜を堆積後、このシリコン窒化膜をエッチバックし、ゲート電極86の側壁部分、及び側壁絶縁膜78が形成されたフローティングゲート68及びコントロールゲート70の側壁部分に、シリコン窒化膜よりなる側壁絶縁膜90を形成する。

【0096】

次いで、ゲート電極86及び側壁絶縁膜90をマスクとして、並びにコントロールゲート及び側壁絶縁膜78, 90をマスクとしてイオン注入を行い、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に不純物拡散領域92を形成し、コントロールゲート70の両側のシリコン基板10内に不純物拡散領域94を形成する。

【0097】

次いで、窒素雰囲気中で熱処理を行い、注入した不純物を活性化し、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に、不純物拡散領域88, 92よりなるソース/ドレイン領域96を形成し、コントロールゲート70の両側のシリコン基板10内に、不純物拡散領域74, 94よりなるソース/ドレイン領域98を形成する(図28(a)、図28(b))。

【0098】

こうして、メモリセル領域に形成され、トンネル絶縁膜34を介してシリコン基板10上に形成されたフローティングゲート68と、ONO膜42を介してフローティングゲート68上に形成されたコントロールゲート70と、コントロールゲート70の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域98とを有する不揮発メモリトランジスタと、低電圧トランジスタ形成領域に形成され、ゲート絶縁膜54を介してシリコン基板10上に形成されたゲート電極86と、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有する低電圧トランジスタと、中電圧トランジスタ形成領域に形成され、ゲート絶縁膜56を介してシリコン基板10上に形成されたゲート電極86と、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有する中電圧トランジスタと、高電圧トランジスタ形成領域に形成され、ゲート絶縁膜58を介してシリコン基板10上に形成されたゲート電極86と、ゲート電極86の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域96とを有する高電圧トランジスタとを完成する。

【0099】

この後、サリサイドプロセスや、多層配線プロセスなどの所定のバックエンドプロセスを経て、半導体装置を完成する。

【0100】

次に、上述の本実施形態による半導体装置の製造方法において、周辺回路領域のONO膜42の除去過程でフルオロカーボン膜を除去する工程を行う目的及び効果について図29乃至図31を用いて説明する。

【0101】

本実施形態による半導体装置の製造方法において、周辺回路領域のONO膜42の除去過程においてフルオロカーボン膜を除去しているのは、高電圧トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧の低下に、フルオロカーボン膜が影響しているためである。

【0102】

前述のように、ONO膜42を除去する工程に至る過程で、素子分離膜28と活性領域(シリコン基板10)との境界には、窪み100が形成されている。ONO膜42のトップ酸化膜及び中間層のシリコン窒化膜を除去するドライエッチングの過程では、窪み100の内壁に、ドライエッチングの副生成物であるフルオロカーボン膜102が堆積される。フルオロカーボン膜102は、窪み100の側壁器部分に堆積されやすいため、窪み1

10

20

30

40

50

00の深部では膜厚が薄くなっているものと考えられる(図29(a)参照)。

【0103】

この状態でボトム酸化膜104のエッチング工程を行うと、フルオロカーボン膜102の付着部分のエッチングレートは遅いため、窪み100の深部におけるエッチングが優先して進行する(図29(b)参照)。

【0104】

この後、ボトム酸化膜104(トンネル絶縁膜34を含む)のエッチングを更に進行すると、先にエッチングが完了した窪み100の深部では素子分離膜28もエッチングされ、窪み100の深部における形状が急峻になる(図29(c)参照)。

【0105】

この窪み100の急峻な形状は、その後の熱酸化によってゲート絶縁膜58を形成した後も保存される。この結果、窪み100内にゲート電極材料が形成されると電界集中が発生し、高電圧トランジスタのゲート絶縁膜58の絶縁耐圧の低下を引き起こすものと考えられる。

【0106】

低電圧トランジスタ及び中電圧トランジスタのゲート絶縁膜54,56では、高電圧トランジスタのゲート絶縁膜58で見られるような絶縁耐圧の低下は認められなかった。低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域では、シリコン酸化膜46を除去した後に再酸化してゲート絶縁膜54,56を形成するため、窪み100の形状が緩和されて電界集中が生じないものと考えられる。

【0107】

本実施形態のようにフルオロカーボン膜を除去する工程を行うことにより、ボトム酸化膜のエッチングが局所的に進行することが防止され、ボトム酸化膜の除去後の窪みの最深部に急峻な窪みが形成されるのを防止することができる。

【0108】

図30はフルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料と行った試料とにおける素子分離膜端部の断面形状を示すTEM像である。図30(a)はフルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料の断面TEM像であり、図30(b)はフルオロカーボン膜を除去する工程を行った試料の断面TEM像である。

【0109】

図示するように、フルオロカーボン膜を除去する工程を行った試料では、フルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料と比較して、窪みの深部(図中、点線で囲った部分)における形状がなだらかになっている。

【0110】

図31は、高電圧トランジスタのゲート電極に逆バイアス(シリコン基板に対して負電圧)を印加したときのゲート絶縁膜耐圧を累積確率分布に表したものである。図中、印がフルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料(比較例)、印が上述の第1の方法によりフルオロカーボン膜を除去する工程を行った試料(実施例1)、印が上述の第2の方法によりフルオロカーボン膜を除去する工程を行った試料(実施例2)である。

【0111】

図示するように、フルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料では、ゲート絶縁膜耐圧のばらつきが大きいのに対し、フルオロカーボン膜を除去する工程を行った試料では、第1の方法及び第2の方法のいずれを用いた場合にも、安定した高いゲート絶縁膜耐圧を得ることができた。

【0112】

このように、本実施形態によれば、周辺回路領域のONO膜を除去する際に、トップ絶縁膜及び中間層を除去した後、表面に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程を行うので、その後のボトム絶縁膜の除去過程において素子分離膜縁部の窪みの形状が変化することを防止することができる。これにより、素子分離膜端部における電界集中が防止され

10

20

30

40

50

、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧劣化を防止することができる。

【0113】

[第2実施形態]

本発明の第2実施形態による半導体装置の製造方法について図32乃至図36を用いて説明する。図1乃至図28に示す第1実施形態による半導体装置及びその製造方法と同様の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し又は簡潔にする。

【0114】

図32は本実施形態による半導体装置の構造を示す平面図及び概略断面図、図33乃至図36は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。

【0115】

はじめに、本実施形態による半導体装置の構造について図32を用いて説明する。図32(a)は本実施形態による半導体装置の平面図であり、図32(b)は図32(a)のA-A線に沿った概略断面図であり、図32(c)は図32(a)のB-B線に沿った概略断面図である。

【0116】

本実施形態による半導体装置は、ONO膜を電荷蓄積層とした単層ゲートの不揮発メモリトランジスタを混載したロジック半導体装置である。本実施形態による半導体装置も、第1実施形態による半導体装置と同様、不揮発メモリトランジスタ(Flash)がマトリクス状に形成されたメモリセル領域と、論理回路を構成するロジックトランジスタや不揮発メモリトランジスタの駆動用の高耐圧トランジスタなどの種々の周辺トランジスタが形成された周辺回路領域を有している。本実施形態による半導体装置、周辺トランジスタとして、例えば、高速ロジック回路を構成する低電圧トランジスタ(LV-Tr)と、入出力回路を構成する中電圧トランジスタ(MV-Tr)と、不揮発メモリトランジスタを制御するための高電圧トランジスタ(HV-Tr)を有している。

【0117】

図32(a)に示すように、メモリセル領域のシリコン基板10内には、不純物拡散層よりなる複数のビット線108がストライプ状に形成されている。ビット線108が形成されたシリコン基板10上には、ビット線108に交差する方向に延在する複数のコントロールゲート70がストライプ状に形成されている。シリコン基板10とコントロールゲート70との間には、ONO膜42(シリコン酸化膜42c/シリコン窒化膜42b/シリコン酸化膜42a)よりなる電荷蓄積層が形成されている(図32(b)及び図32(c)を参照)。

【0118】

これにより、隣接するビット線108線間の領域とコントロールゲート70との交差部にそれぞれ、コントロールゲート70と、当該隣接するビット線108により構成されるソース/ドレイン領域とを有し、ONO膜42を電荷蓄積層とする不揮発メモリトランジスタが構成されている。コントロールゲート70間の領域には、図32(c)に示すように、シリコン酸化膜80よりなるライナー膜と、シリコン窒化膜76が埋め込まれている。なお、図32(b)及び図32(c)では説明の便宜上、両端に素子分離膜28を記載しているが、実際には、素子分離膜28はメモリセル領域の周辺を囲うように形成される。

【0119】

周辺回路領域に形成された低電圧トランジスタ(LV-Tr)、中電圧トランジスタ(MV-Tr)及び高電圧トランジスタ(HV-Tr)は、第1実施形態による半導体装置の場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。

【0120】

次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図33乃至図36を用いて説明する。図33及び図34は図32のA-A線に沿った工程断面図であり、図35及び図36は図32(a)のB-B線に沿った工程断面図である。

【0121】

10

20

30

40

50

なお、周辺トランジスタの製造プロセスは第1実施形態による半導体装置の製造方法と基本的に同じであるため、ここでは不揮発メモリトランジスタの製造プロセスを中心に説明する。周辺トランジスタの製造プロセスについては、必要に応じて第1実施形態の図面を参照しながら説明する。

【0122】

まず、図3乃至図10に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、STI法により、活性領域を画定する素子分離膜28を形成する。

【0123】

次いで、素子分離膜28により画定されたシリコン基板10の活性領域上に、例えば熱酸化法により、シリコン酸化膜よりなる犠牲酸化膜32を形成する(図33(a))。 10

【0124】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、メモリセル領域及び高電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル(図示せず)を形成する。例えば、メモリセル領域及びN型高電圧トランジスタ形成領域にはN型ウェル内にP型ウェルが形成された二重ウェルを形成し、P型高電圧トランジスタ形成領域にはN型ウェルを形成する。

【0125】

次いで、窒素雰囲気中で、例えば900~1200の温度で1~15秒間の熱処理を行い、注入した不純物を活性化する。

【0126】

次いで、例えば純水により10:1~200:1程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、犠牲酸化膜32を除去する。 20

【0127】

なお、素子分離膜28は、シリコン酸化膜12や犠牲酸化膜32の除去工程などにおいて徐々に膜減りする。これにより、犠牲酸化膜32を除去した後は、素子分離膜28と活性領域との境目に、活性領域表面より窪んだ窪みが形成されている。

【0128】

次いで、シリコン基板10の表面に、熱酸化法により、例えば膜厚5~14nmのシリコン酸化膜42aを形成する。

【0129】

次いで、全面に、例えば熱CVD法により、例えば膜厚が5~14nmのシリコン窒化膜42bを形成する(図33(b))。 30

【0130】

次いで、シリコン窒化膜42b上に、フォトリソグラフィにより、周辺回路領域の全面を覆い、メモリセル領域のビット線形成領域を露出するフォトレジスト膜40を形成する(図33(c))。

【0131】

次いで、フォトレジスト膜40をマスクとしてイオン注入を行い、メモリセル領域内に、ビット線108となる不純物拡散領域110と、不純物拡散領域110の縁部に設けられたポケット領域としての不純物拡散領域112とを形成する(図34(a))。 40

【0132】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、シリコン窒化膜42b上のフォトレジスト膜40を除去する。

【0133】

次いで、シリコン窒化膜42b上に、シリコン酸化膜42cを形成する。シリコン酸化膜42cは、例えば、熱酸化法によりシリコン窒化膜42bを熱酸化した後、熱CVD法により高温酸化(HTO:High Temperature Oxide)膜を形成することにより、形成する。

【0134】

こうして、シリコン酸化膜42c/シリコン窒化膜42b/シリコン酸化膜42bの積層膜を形成し、ONO膜42よりなる電荷蓄積層とする(図34(b))。このように形 50

成したONO膜42は、第1実施形態の場合と同様、周辺回路領域にも形成される(図15(a)参照)。

【0135】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル(図示せず)を形成する。例えば、N型低電圧トランジスタ形成領域及びN型中電圧トランジスタ形成領域にP型ウェルを形成し、P型低電圧トランジスタ形成領域及びP型中電圧トランジスタ形成領域にN型ウェルを形成する。

【0136】

次いで、図15(a)~図16(a)に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、周辺回路領域のONO膜42を除去する。本実施形態の場合にも、ONO膜42は、素子分離膜28と活性領域との境目の窪み内にも形成されている。そこで、シリコン酸化膜42c及びシリコン窒化膜42bを除去した後は、第1実施形態と同様のフルオロカーボン膜の除去工程を行い、高電圧トランジスタの絶縁耐圧劣化を防止する。

10

【0137】

具体的には、周辺回路領域を露出しメモリセル領域を覆うフォトレジスト膜44を形成後、このフォトレジスト膜44をマスクとして、例えばマグネトロン反応性イオンエッチング装置を用いたドライエッチングにより、シリコン酸化膜42c及びシリコン窒化膜42bをエッチングする。次いで、シリコン酸化膜42c及びシリコン窒化膜42bのエッチングに伴い基板の表面に付着したフルオロカーボン膜を、第1実施形態に記載の第1の方法又は第2の方法により、除去する。次いで、フォトレジスト膜44をマスクとして、例えば純水により100:1~200:1程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、シリコン酸化膜42aを除去する。次いで、アッシング及びその後の後処理により、フォトレジスト膜44を除去する。

20

【0138】

このようにしてONO膜42を除去することにより、素子分離膜28と活性領域との境目の窪みの形状が変化することを防止することができる。

【0139】

次いで、図17(a)~図21(a)に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、低電圧トランジスタ形成領域、中電圧トランジスタ形成領域及び高電圧トランジスタ形成領域に、互いに膜厚の異なる3種類のゲート絶縁膜52, 54, 56を形成する(図21(a)参照)。

30

【0140】

次いで、全面に、例えばCVD法により、例えば膜厚50~200nmのポリシリコン膜60を形成する。ポリシリコン膜60は、不揮発メモリトランジスタのコントロールゲート70及び周辺トランジスタのゲート電極84となる膜である。

【0141】

次いで、ポリシリコン膜60上に、例えばCVD法により、例えば膜厚15~40nmのシリコン酸化膜114を形成する(図34(c))。

【0142】

次いで、シリコン酸化膜114上に、スピンコート法により、BARC膜64とフォトレジスト膜66とを形成する。

40

【0143】

次いで、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜66をパターニングし、周辺回路領域の全面及びメモリセル領域のコントロールゲート形成領域を覆うフォトレジスト膜66を形成する(図35(a))。

【0144】

次いで、フォトレジスト膜66をマスクとして、例えば誘導結合型プラズマエッチング装置を用いた異方性エッチングにより、BARC膜64、シリコン酸化膜114及びポリシリコン膜60をパターニングし、メモリセル領域に、ポリシリコン膜60よりなるコン

50

トロールゲート70を形成する。

【0145】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、ポリシリコン膜60上に残存するシリコン酸化膜114、BARC膜64及びフォトレジスト膜66を除去する(図35(b))。なお、周辺回路領域は、ポリシリコン膜60によって全面が覆われたままの状態である(図25(a)参照)。

【0146】

次いで、全面に、例えば熱CVD法により、例えば膜厚1~20nmのシリコン酸化膜80と、例えば膜厚50~170nmのシリコン窒化膜76とを形成する(図36(a))。

10

【0147】

次いで、ドライエッチングにより、シリコン酸化膜80の上面が露出するまでシリコン窒化膜76を異方性エッチングし、コントロールゲート70間の間隙を、シリコン酸化膜116及びシリコン窒化膜76により埋め込む(図36(b))。こうして、本実施形態の不揮発メモリトランジスタを完成する。

【0148】

次いで、図26乃至図28に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、周辺回路領域のポリシリコン膜60をパターニングしてゲート電極84を形成後、ソース/ドレイン領域96を形成し、低電圧トランジスタ、中電圧トランジスタ及び高電圧トランジスタを完成する。

20

【0149】

この後、サリサイドプロセスや、多層配線プロセスなどの所定のバックエンドプロセスを経て、半導体装置を完成する。

【0150】

このように、本実施形態によれば、周辺回路領域のONO膜を除去する際に、トップ絶縁膜及び中間層を除去した後、表面に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程を行うので、その後のボトム絶縁膜の除去過程において素子分離膜縁部の窪みの形状が変化することを防止することができる。これにより、素子分離膜端部における電界集中が防止され、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧劣化を防止することができる。

30

【0151】

[第3実施形態]

本発明の第3実施形態による半導体装置の製造方法について図37乃至図40を用いて説明する。図1乃至図28に示す第1実施形態による半導体装置及びその製造方法、並びに図32乃至図36に示す第2実施形態による半導体装置及びその製造方法と同様の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し又は簡潔にする。

【0152】

図37は本実施形態による半導体装置の構造を示す平面図及び概略断面図、図38乃至図40は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。

【0153】

はじめに、本実施形態による半導体装置の構造について図37を用いて説明する。図37(a)は本実施形態による半導体装置の平面図であり、図37(b)は図37(a)のA-A線に沿った概略断面図であり、図37(c)は図37(a)のB-B線に沿った概略断面図である。

40

【0154】

本実施形態による半導体装置は、ONO膜を電荷蓄積層とした単層ゲートの不揮発メモリトランジスタを混載したロジック半導体装置である。本実施形態による半導体装置も、第1実施形態による半導体装置と同様、不揮発メモリトランジスタ(Flash)がマトリクス状に形成されたメモリセル領域と、論理回路を構成するロジックトランジスタや不揮発メモリトランジスタの駆動用の高耐圧トランジスタなどの種々の周辺トランジスタが形成された周辺回路領域を有している。本実施形態による半導体装置、周辺トランジスタ

50

として、例えば、高速ロジック回路を構成する低電圧トランジスタ（LV-Tr）と、入出力回路を構成する中電圧トランジスタ（MV-Tr）と、不揮発メモリトランジスタを制御するための高電圧トランジスタ（HV-Tr）を有している。

【0155】

図37(a)に示すように、メモリセル領域のシリコン基板10内には、複数の素子分離膜28がストライプ状に形成されている。素子分離膜28が形成されたシリコン基板10上には、素子分離膜28に交差する方向に延在する複数のコントロールゲート70がストライプ状に形成されている。シリコン基板10とコントロールゲート70との間には、ONO膜42（シリコン酸化膜42c/シリコン窒化膜42b/シリコン酸化膜42a）よりなる電荷蓄積層が形成されている。コントロールゲート70間の領域のシリコン基板10内には、ソース/ドレイン領域98が形成されている。（図37(b)及び図37(c)を参照）。

10

【0156】

これにより、隣接する素子分離膜28間の領域とコントロールゲート70との交差部にそれぞれ、コントロールゲート70と、コントロールゲート70の両側のシリコン基板10内に形成されたソース/ドレイン領域98とを有し、ONO膜42を電荷蓄積層とする不揮発メモリトランジスタが構成されている。コントロールゲート70間の領域には、図37(c)に示すように、シリコン酸化膜80よりなるライナー膜と、シリコン窒化膜76が埋め込まれている。

20

【0157】

周辺回路領域に形成された低電圧トランジスタ（LV-Tr）、中電圧トランジスタ（MV-Tr）及び高電圧トランジスタ（HV-Tr）は、第1実施形態による半導体装置の場合と同様であるので、ここでは説明を省略する。

【0158】

次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図38乃至図40を用いて説明する。図38は図37のA-A線に沿った工程断面図であり、図39及び図40は図37(a)のB-B線に沿った工程断面図である。

【0159】

なお、周辺トランジスタの製造プロセスは第1実施形態による半導体装置の製造方法と基本的に同じであるため、ここでは不揮発メモリトランジスタの製造プロセスを中心に説明する。周辺トランジスタの製造プロセスについては、必要に応じて第1実施形態の図面を参照しながら説明する。

30

【0160】

まず、図3乃至図10に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、STI法により、活性領域を画定する素子分離膜28を形成する。

【0161】

次いで、素子分離膜28により画定されたシリコン基板10の活性領域上に、例えば熱酸化法により、シリコン酸化膜よりなる犠牲酸化膜32を形成する（図38(a)）。

【0162】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、メモリセル領域及び高電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル（図示せず）を形成する。例えば、メモリセル領域及びN型高電圧トランジスタ形成領域にはN型ウェル内にP型ウェルが形成された二重ウェルを形成し、P型高電圧トランジスタ形成領域にはN型ウェルを形成する。

40

【0163】

次いで、窒素雰囲気中で、例えば900～1200の温度で1～15秒間の熱処理を行い、注入した不純物を活性化する。

【0164】

次いで、例えば純水により10：1～200：1程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、犠牲酸化膜32を除去する。

【0165】

50

なお、素子分離膜 2 8 は、シリコン酸化膜 1 2 や犠牲酸化膜 3 2 の除去工程などにおいて徐々に膜減りする。これにより、犠牲酸化膜 3 2 を除去した後は、素子分離膜 2 8 と活性領域との境目に、活性領域表面より窪んだ窪みが形成されている。

【 0 1 6 6 】

次いで、シリコン基板 1 0 の表面に、熱酸化法により、例えば膜厚 5 ~ 1 4 n m のシリコン酸化膜 4 2 a を形成する。

【 0 1 6 7 】

次いで、全面に、例えば熱 C V D 法により、例えば膜厚が 5 ~ 1 4 n m のシリコン窒化膜 4 2 b を形成する (図 3 3 (b)) 。

【 0 1 6 8 】

次いで、シリコン窒化膜 4 2 b 上に、例えば熱酸化法により、例えば膜厚が 3 ~ 1 5 n m のシリコン酸化膜 4 2 c を形成する。

【 0 1 6 9 】

こうして、シリコン酸化膜 4 2 c / シリコン窒化膜 4 2 b / シリコン酸化膜 4 2 b の積層膜を形成し、ONO 膜 4 2 よりなる電荷蓄積層とする (図 3 8 (b)) 。このように形成した ONO 膜 4 2 は、第 1 実施形態の場合と同様、周辺回路領域にも形成される (図 1 5 (a) 参照) 。

【 0 1 7 0 】

次いで、フォトリソグラフィ及びイオン注入により、低電圧トランジスタ形成領域及び中電圧トランジスタ形成領域に所定のウェル (図示せず) を形成する。例えば、N 型低電圧トランジスタ形成領域及び N 型中電圧トランジスタ形成領域に P 型ウェルを形成し、P 型低電圧トランジスタ形成領域及び P 型中電圧トランジスタ形成領域に N 型ウェルを形成する。

【 0 1 7 1 】

次いで、図 1 5 (a) ~ 図 1 6 (a) に示す第 1 実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、周辺回路領域の ONO 膜 4 2 を除去する。本実施形態の場合にも、ONO 膜 4 2 は、素子分離膜 2 8 と活性領域との境目の窪み内にも形成されている。そこで、シリコン酸化膜 4 2 c 及びシリコン窒化膜 4 2 b を除去した後は、第 1 実施形態と同様のフルオロカーボン膜の除去工程を行い、高電圧トランジスタの絶縁耐圧劣化を防止する。

【 0 1 7 2 】

具体的には、周辺回路領域を露出しメモリセル領域を覆うフォトレジスト膜 4 4 を形成後、このフォトレジスト膜 4 4 をマスクとして、例えばマグネトロン反応性イオンエッチング装置を用いたドライエッチングにより、シリコン酸化膜 4 2 c 及びシリコン窒化膜 4 2 b をエッチングする。次いで、シリコン酸化膜 4 2 c 及びシリコン窒化膜 4 2 b のエッチングに伴い基板の表面に付着したフルオロカーボン膜を、第 1 実施形態に記載の第 1 の方法又は第 2 の方法により、除去する。次いで、フォトレジスト膜 4 4 をマスクとして、例えば純水により 1 0 0 : 1 ~ 2 0 0 : 1 程度に希釈された弗酸水溶液によりウェットエッチングを行い、シリコン酸化膜 4 2 a を除去する。次いで、アッシング及びその後の後処理により、フォトレジスト膜 4 4 を除去する。

【 0 1 7 3 】

このようにして ONO 膜 4 2 を除去することにより、素子分離膜 2 8 と活性領域との境目の窪みの形状が変化することを防止することができる。

【 0 1 7 4 】

次いで、図 1 7 (a) ~ 図 2 1 (a) に示す第 1 実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、低電圧トランジスタ形成領域、中電圧トランジスタ形成領域及び高電圧トランジスタ形成領域に、互いに膜厚の異なる 3 種類のゲート絶縁膜 5 2 , 5 4 , 5 6 を形成する (図 2 1 (a) 参照) 。

【 0 1 7 5 】

次いで、全面に、例えば C V D 法により、例えば膜厚 5 0 ~ 2 0 0 n m のポリシリコン膜 6 0 を形成する。ポリシリコン膜 6 0 は、不揮発メモリトランジスタのコントロールゲ

10

20

30

40

50

ート70及び周辺トランジスタのゲート電極84となる膜である。

【0176】

次いで、ポリシリコン膜60上に、例えばCVD法により、例えば膜厚15～40nmのシリコン酸化膜114を形成する(図38(c))。

【0177】

次いで、シリコン酸化膜114上に、スピンコート法により、BARC膜64とフォトレジスト膜66とを形成する。

【0178】

次いで、フォトリソグラフィによりフォトレジスト膜66をパターニングし、周辺回路領域の全面及びメモリセル領域のコントロールゲート形成領域を覆うフォトレジスト膜66を形成する(図39(a))。

10

【0179】

次いで、フォトレジスト膜66をマスクとして、例えば誘導結合型プラズマエッチング装置を用いた異方性エッチングにより、BARC膜64、シリコン酸化膜114及びポリシリコン膜60をパターニングし、メモリセル領域に、ポリシリコン膜60よりなるコントロールゲート70を形成する。

【0180】

次いで、フォトレジスト膜66及びコントロールゲート70をマスクとしてイオン注入を行い、コントロールゲート70間の領域に、ソース/ドレイン領域98となる不純物拡散領域74を形成する。

20

【0181】

次いで、アッシング及びその後の後処理により、ポリシリコン膜60上に残存するシリコン酸化膜114、BARC膜64及びフォトレジスト膜66を除去する(図39(b))。なお、周辺回路領域は、ポリシリコン膜60によって全面が覆われたままの状態である(図25(a)参照)。

【0182】

次いで、全面に、例えば熱CVD法により、例えば膜厚1～20nmのシリコン酸化膜80と、例えば膜厚50～170nmのシリコン窒化膜76とを形成する(図40(a))。

【0183】

次いで、ドライエッチングにより、シリコン酸化膜80の上面が露出するまでシリコン窒化膜76を異方性エッチングし、コントロールゲート70間の間隙を、シリコン酸化膜116及びシリコン窒化膜76により埋め込む(図40(b))。こうして、本実施形態の不揮発メモリトランジスタを完成する。

30

【0184】

次いで、図26乃至図28に示す第1実施形態による半導体装置の製造方法と同様にし、周辺回路領域のポリシリコン膜60をパターニングしてゲート電極84を形成後、ソース/ドレイン領域96を形成し、低電圧トランジスタ、中電圧トランジスタ及び高電圧トランジスタを完成する。

【0185】

この後、サリサイドプロセスや、多層配線プロセスなどの所定のバックエンドプロセスを経て、半導体装置を完成する。

40

【0186】

このように、本実施形態によれば、周辺回路領域のONO膜を除去する際に、トップ絶縁膜及び中間層を除去した後、表面に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程を行うので、その後のボトム絶縁膜の除去過程において素子分離膜縁部の窪みの形状が変化することを防止することができる。これにより、素子分離膜端部における電界集中が防止され、周辺トランジスタのゲート絶縁膜の絶縁耐圧劣化を防止することができる。

【0187】

[変形実施形態]

50

本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。

【0188】

例えば、上記実施形態では、ゲート間絶縁膜又は電荷蓄積層としてのONO膜を除去する際に本発明を適用した場合を説明したが、本発明の適用対象はONO膜に限定されるものではない。本発明は、素子分離領域とエッチング特性の同等な下層絶縁膜と、この下層絶縁膜上に形成された上層絶縁膜を有し、上層絶縁膜のエッチングにフルオロカーボン系のガスを用いる製造プロセスを用いた半導体装置の製造方法に広く適用することができる。

【0189】

シリコン系の半導体デバイスでは、下層絶縁膜として、シリコン酸化物系の絶縁膜（シリコン酸化膜やシリコン窒化酸化膜）を適用することができる。また、上層絶縁膜としては、シリコン窒化膜の単層、シリコン窒化膜とシリコン酸化膜との積層膜や、アルミナ（ Al_2O_3 ）膜やハフニア（ HfO_2 ）膜等の高誘電率絶縁膜を含む膜等を適用することができる。

10

【0190】

また、上層絶縁膜のエッチングに用いるフルオロカーボン系のガスとしては、上記実施形態に記載のガスに限らず、ハイドロフルオロカーボン（HFC）やフルオロカーボン（FC）などのフロン類のガスを用いることができる。

【0191】

また、上記実施形態に記載の半導体装置の構造やプロセス条件は、一例を示したものであり、必要に応じて適宜変更できるものである。

20

【0192】

また、上記実施形態では、不揮発メモリトランジスタを混載したロジック半導体装置の製造プロセスに適用した例を示したが、本発明は、不揮発メモリトランジスタを混載したロジック半導体装置への適用に限定されるものではない。

【0193】

上述のように本発明は、素子分離領域とエッチング特性の同等な下層絶縁膜と、この下層絶縁膜上に形成された上層絶縁膜を有し、上層絶縁膜のエッチングにフルオロカーボン系のガスを用いる製造プロセスを用いた半導体装置の製造方法に広く適用できるものである。特に、下層絶縁膜の下地が段差を有する場合に、本発明を適用する効果がある。

30

【0194】

以上詳述したように、本発明の特徴をまとめると以下の通りとなる。

【0195】

（付記1） 半導体基板の表面に、活性領域を画定する素子分離領域を形成する工程と

、
前記素子分離領域が形成された前記半導体基板上に、第1の絶縁膜を形成する工程と、
前記第1の絶縁膜が形成された前記半導体基板上に、前記第1の絶縁膜とはエッチング特性の異なる第2の絶縁膜を形成する工程と、

少なくとも前記活性領域と前記素子分離領域との境界を含む第1の領域に形成された前記第2の絶縁膜を、フルオロカーボン系のエッチングガスを用いたドライエッチングにより除去する工程と、

40

酸素を含む雰囲気曝露することにより、前記ドライエッチングの際に前記第1の絶縁膜上に付着したフルオロカーボン膜を除去する工程と、

前記第1の領域に形成された前記第1の絶縁膜を、ウェットエッチングにより除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0196】

（付記2） 付記1記載の半導体装置の製造方法において、

前記フルオロカーボン膜を除去する工程では、アルゴンガスと酸素ガスとを含む混合ガスを用いた反応性イオンエッチングにより、前記フルオロカーボン膜を除去する

50

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0197】

(付記3) 付記2記載の半導体装置の製造方法において、前記酸素ガスの流量は、プロセスガスの総流量に対して、0.5～25%であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0198】

(付記4) 付記2又は3記載の半導体装置の製造方法において、前記第2の絶縁膜を除去する工程と、前記フルオロカーボン膜を除去する工程は、同一の処理室内で連続して行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。

10

【0199】

(付記5) 付記1記載の半導体装置の製造方法において、前記フルオロカーボン膜を除去する工程では、 CF_4 ガスと酸素ガスとを含む混合ガスを用いたケミカルドライエッチングにより、前記フルオロカーボン膜を除去することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0200】

(付記6) 付記5記載の半導体装置の製造方法において、前記混合ガスは、フォーミングガスを更に含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0201】

20

(付記7) 付記5又は6記載の半導体装置の製造方法において、前記 CF_4 ガスの流量は、プロセスガスの総流量に対して、0.05～10%であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0202】

(付記8) 付記1乃至7のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法において、前記素子分離領域を形成する工程の後、前記第1の絶縁膜を形成する工程の前に、前記素子分離領域を構成する第3の絶縁膜の上部をエッチングする工程を更に有し、前記第1の絶縁膜の形成の際、前記活性領域と前記素子分離領域との前記境界近傍の前記素子分離領域に、前記活性領域の表面よりも窪んだ窪みが形成されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

30

【0203】

(付記9) 付記8記載の半導体装置の製造方法において、前記第3の絶縁膜は、前記第1の絶縁膜と同等のエッチング特性を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0204】

(付記10) 付記1乃至9のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法において、前記第1の絶縁膜を除去する工程の後、前記第1の領域内の前記活性領域にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する工程とを更に有し、前記第1の領域内の前記活性領域に、前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極を有するMISトランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

40

【0205】

(付記11) 付記10記載の半導体装置の製造方法において、前記ゲート電極を形成する工程では、前記第1の絶縁膜を除去することにより露出した前記半導体基板を熱酸化することにより形成した第4の絶縁膜を少なくとも含む前記ゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0206】

(付記12) 付記1乃至11のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法において

50

前記第 1 の領域とは異なる第 2 の領域内の活性領域に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を有する不揮発メモリトランジスタを形成する工程を更に有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0207】

(付記 13) 付記 12 記載の半導体装置の製造方法において、前記素子分離領域を形成する工程の後、前記第 1 の絶縁膜を形成する工程の前に、前記第 2 の領域内の前記活性領域上にトンネル絶縁膜を形成する工程と、前記トンネル絶縁膜上に、前記第 2 の領域にフローティングゲートを形成する工程とを、前記第 1 の絶縁膜を除去する工程の後に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を介して前記フローティングゲート上にコントロールゲートを形成する工程を、更に有し、前記フローティングゲートと前記コントロールゲートとを有するスタックゲート構造の前記不揮発メモリトランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

10

【0208】

(付記 14) 付記 12 記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 の絶縁膜を除去する工程の後に、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を介してコントロールゲートを形成する工程を更に有し、前記第 1 の絶縁膜及び前記第 2 の絶縁膜を電荷蓄積層とする単層ゲート構造の前記不揮発メモリトランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

20

【0209】

(付記 15) 付記 1 乃至 14 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、前記素子分離領域を形成する工程では、前記半導体基板に形成されたトレンチに絶縁膜を埋め込むことにより、前記素子分離領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0210】

(付記 16) 付記 1 乃至 15 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、前記第 1 の絶縁膜は、シリコン酸化膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

30

【0211】

(付記 17) 付記 1 乃至 16 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、前記第 2 の絶縁膜は、シリコン窒化膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0212】

(付記 18) 付記 1 乃至 16 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法において、前記第 2 の絶縁膜は、シリコン窒化膜とシリコン酸化膜との積層膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。

40

【図面の簡単な説明】

【0213】

- 【図 1】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の構造を示す平面図である。
 【図 2】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
 【図 3】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。
 【図 4】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。
 【図 5】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 3）

50

である。

【図 6】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 4）である。

【図 7】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 5）である。

【図 8】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 6）である。

【図 9】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 7）である。

【図 10】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 8）である。

10

【図 11】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 9）である。

【図 12】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 10）である。

【図 13】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 11）である。

【図 14】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 12）である。

【図 15】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 13）である。

20

【図 16】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 14）である。

【図 17】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 15）である。

【図 18】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 16）である。

【図 19】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 17）である。

【図 20】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 18）である。

30

【図 21】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 19）である。

【図 22】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 20）である。

【図 23】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 21）である。

【図 24】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 22）である。

【図 25】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 23）である。

40

【図 26】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 24）である。

【図 27】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 25）である。

【図 28】本発明の第 1 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 26）である。

【図 29】ONO 膜の除去過程におけるフルオロカーボン膜の影響を説明する図である。

【図 30】フルオロカーボン膜を除去する工程を行っていない試料と行った試料とにおける素子分離膜端部の断面形状を示す TEM 像である。

50

【図 3 1】高電圧トランジスタのゲート電極に逆バイアスを印加したときのゲート絶縁膜耐圧を示すグラフである。

【図 3 2】本発明の第 2 実施形態による半導体装置の構造を示す平面図及び概略断面図である。

【図 3 3】本発明の第 2 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 3 4】本発明の第 2 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 3 5】本発明の第 2 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 3）である。

【図 3 6】本発明の第 2 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 4）である。

【図 3 7】本発明の第 3 実施形態による半導体装置の構造を示す平面図及び概略断面図である。

【図 3 8】本発明の第 3 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 3 9】本発明の第 3 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 4 0】本発明の第 3 実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その 3）である。

【符号の説明】

【 0 2 1 4 】

1 0 ... シリコン基板

1 2 , 2 4 , 2 6 , 4 2 a、4 2 c , 4 6 , 5 0 , 8 0 , 1 1 4 ... シリコン酸化膜

1 4 , 4 2 b , 6 2 , 7 6 ... シリコン窒化膜

1 6 , 3 6 , 6 0 ... ポリシリコン膜

1 8 , 3 8 , 6 4 , 8 2 ... B A R C 膜

2 0 , 3 0 , 4 0 , 4 4 , 4 8 , 5 2 , 6 6 , 8 4 ... フォトレジスト膜

2 2 ... トレンチ

2 8 ... 素子分離膜

3 2 ... 犠牲酸化膜

3 4 ... トンネル絶縁膜

4 2 ... O N O 膜

5 4 , 5 6 , 5 8 ... ゲート絶縁膜

6 8 ... フローティングゲート

7 0 ... コントロールゲート

7 2 , 7 8 , 9 0 ... 側壁絶縁膜

7 4 , 8 8 , 9 2 , 9 4 , 1 1 0 , 1 1 2 ... 不純物拡散領域

8 6 ... ゲート電極

9 6 , 9 8 ... ソース/ドレイン領域

1 0 0 ... 窪み

1 0 2 ... フルオロカーボン膜

1 0 4 ... ボトム酸化膜

1 0 8 ... ビット線

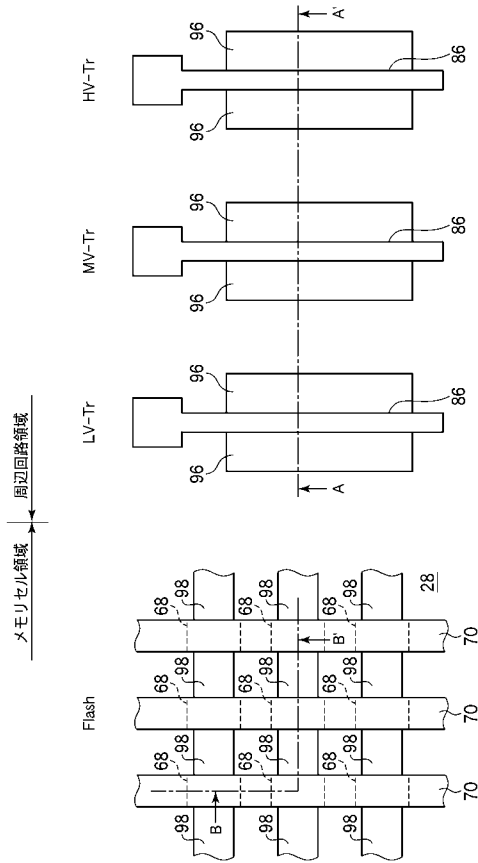
10

20

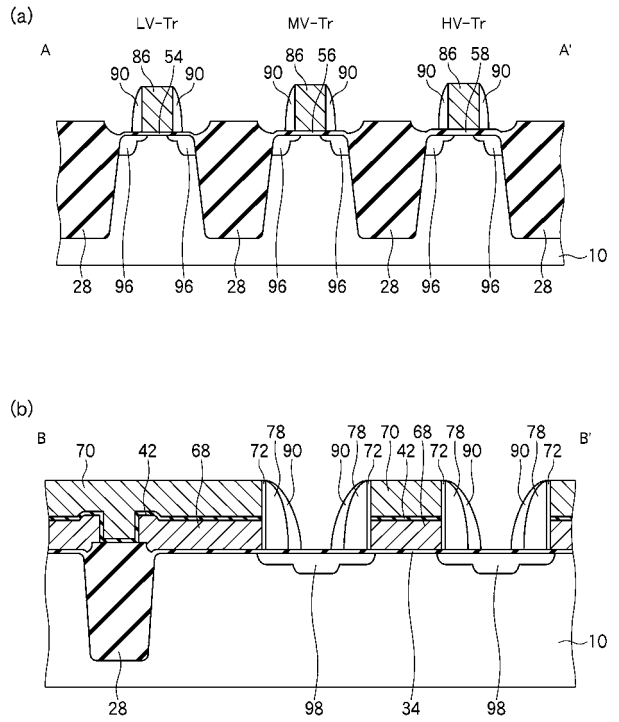
30

40

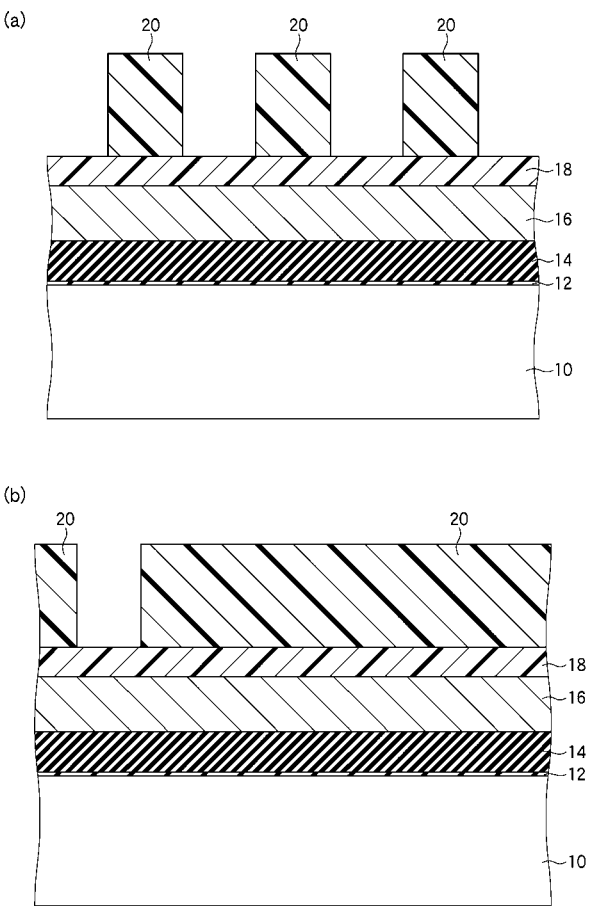
【 図 1 】



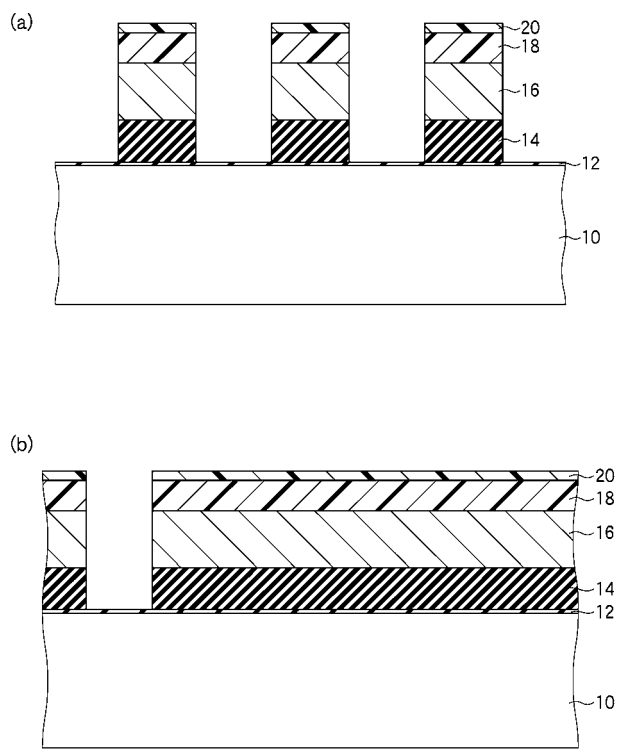
【 図 2 】



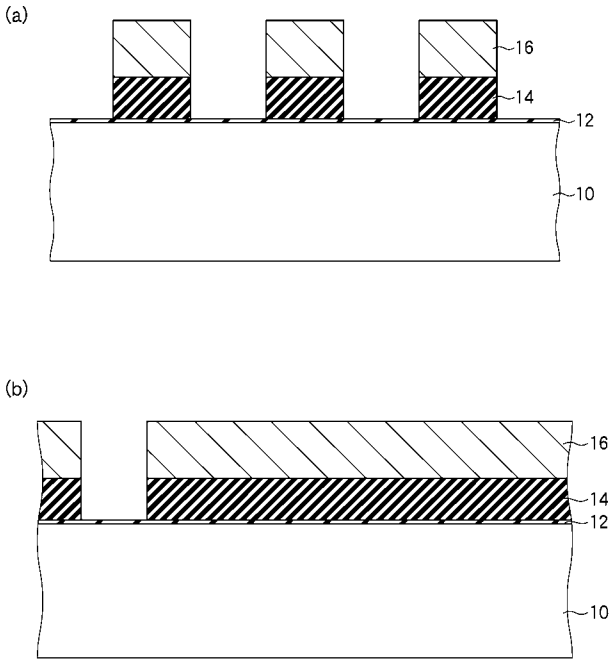
【 図 3 】



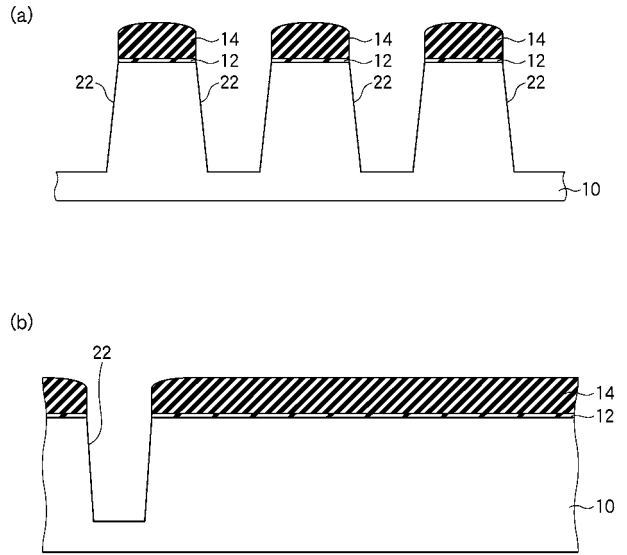
【 図 4 】



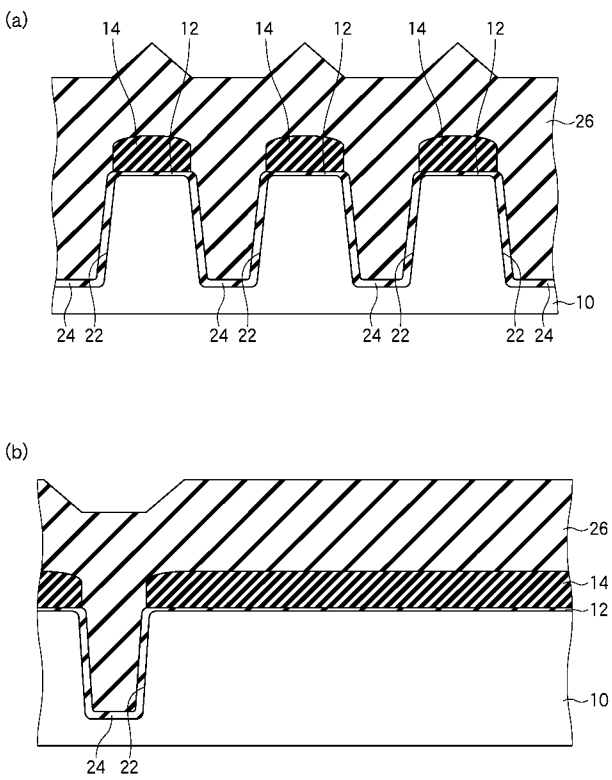
【 図 5 】



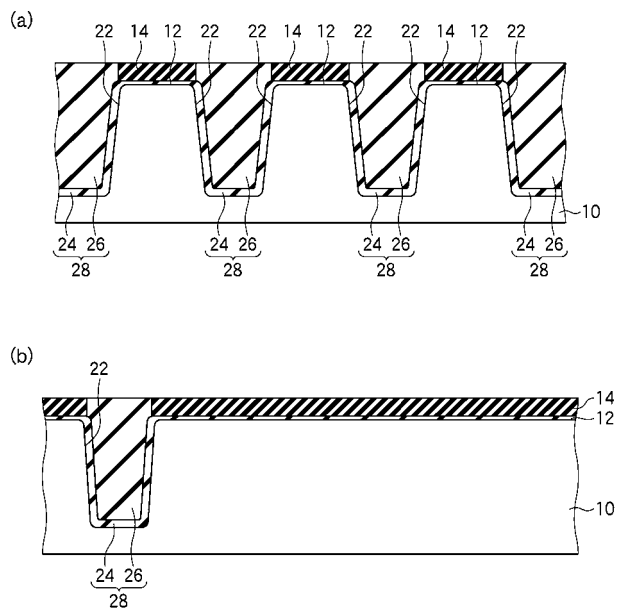
【 図 6 】



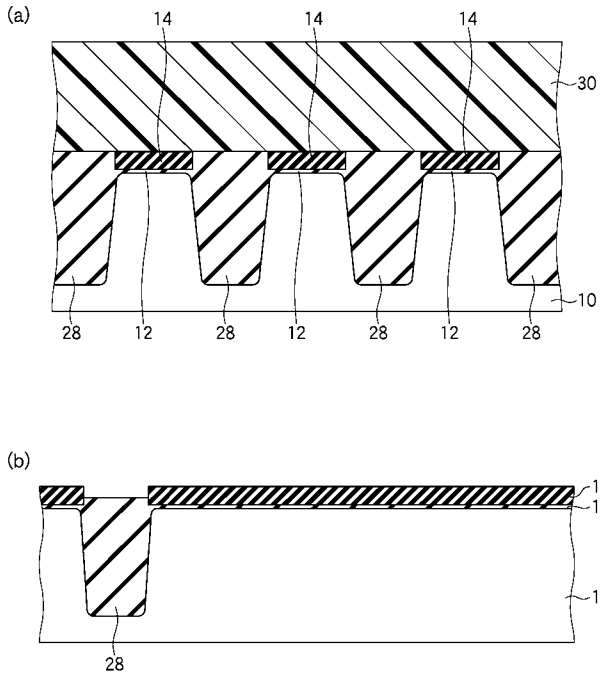
【 図 7 】



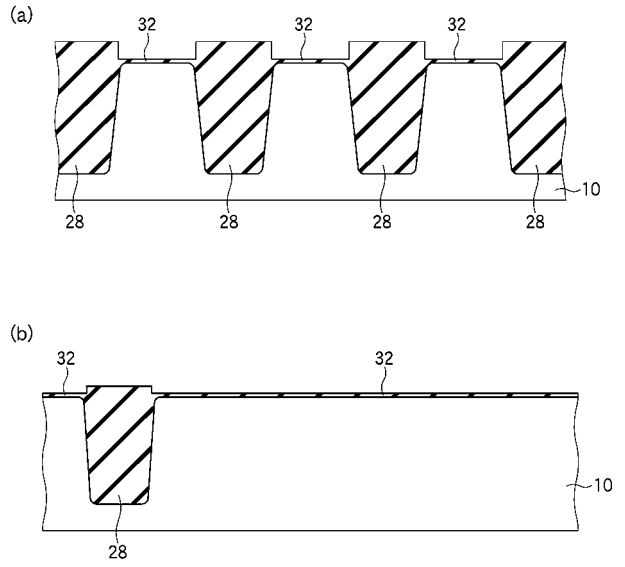
【 図 8 】



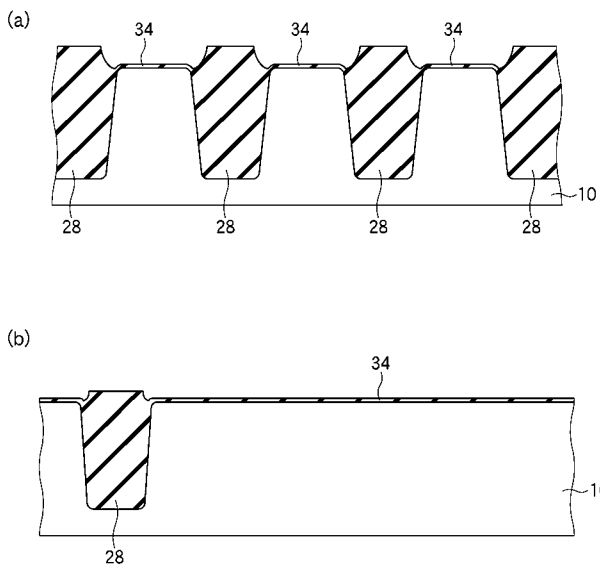
【 図 9 】



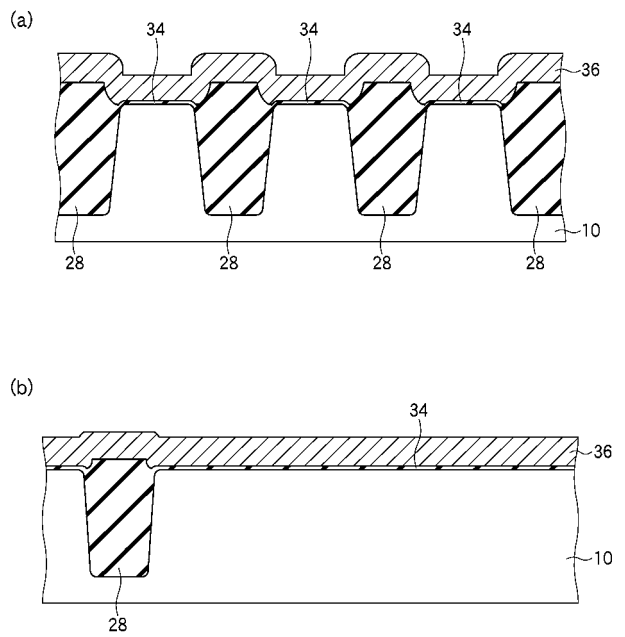
【 図 10 】



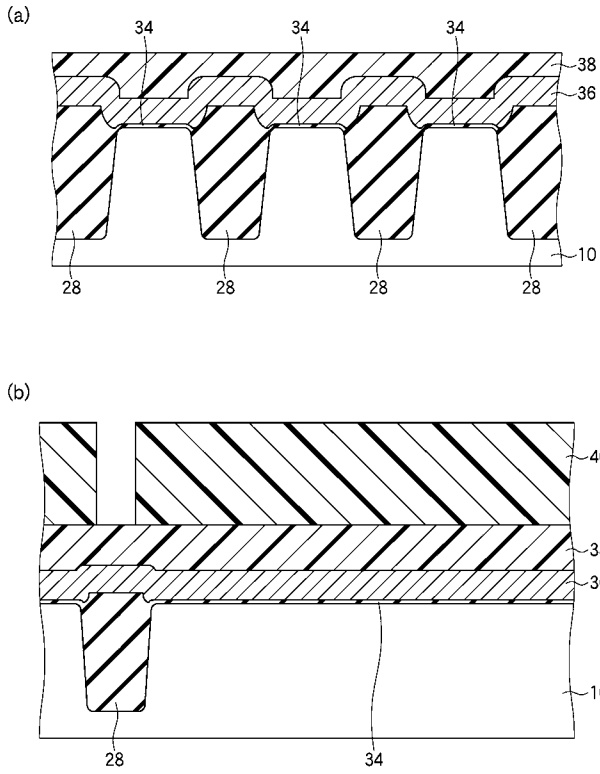
【 図 11 】



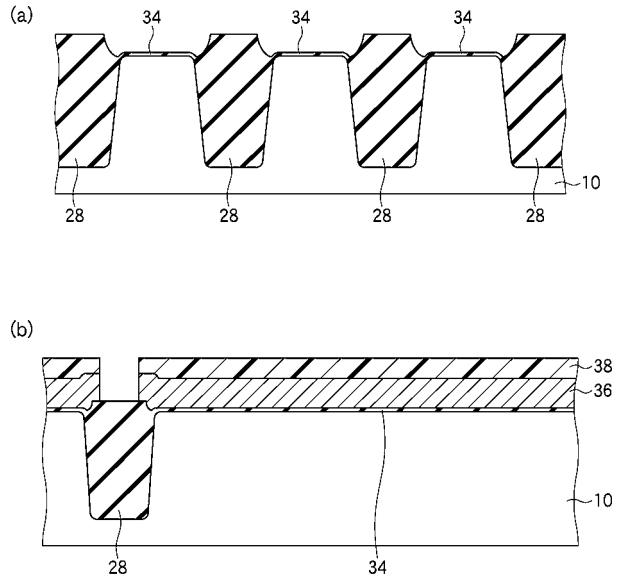
【 図 12 】



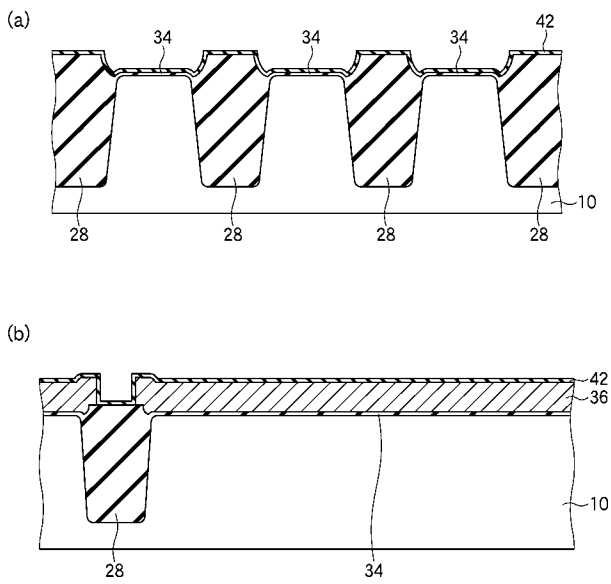
【 図 1 3 】



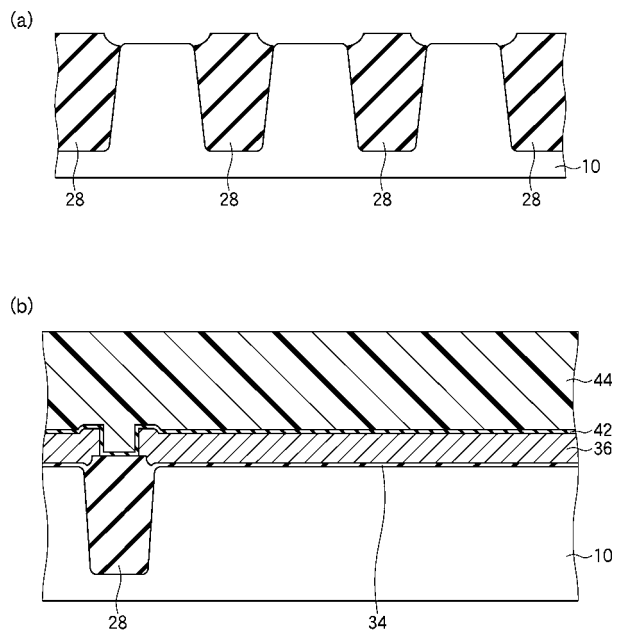
【 図 1 4 】



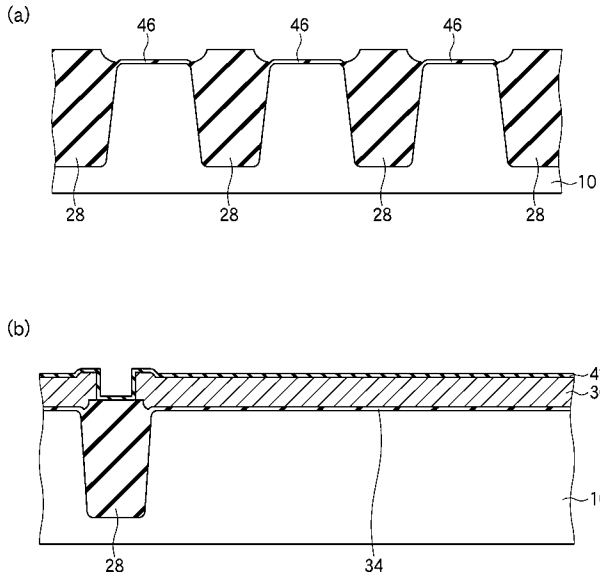
【 図 1 5 】



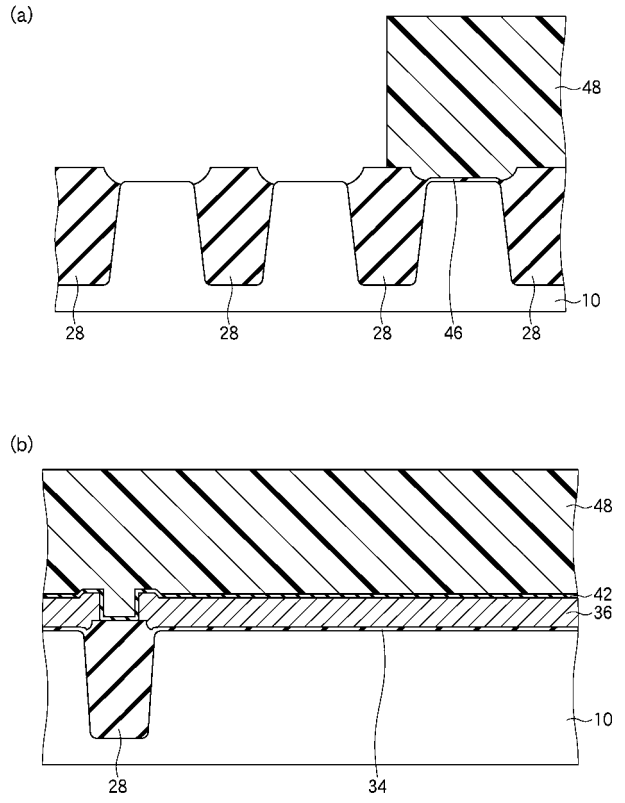
【 図 1 6 】



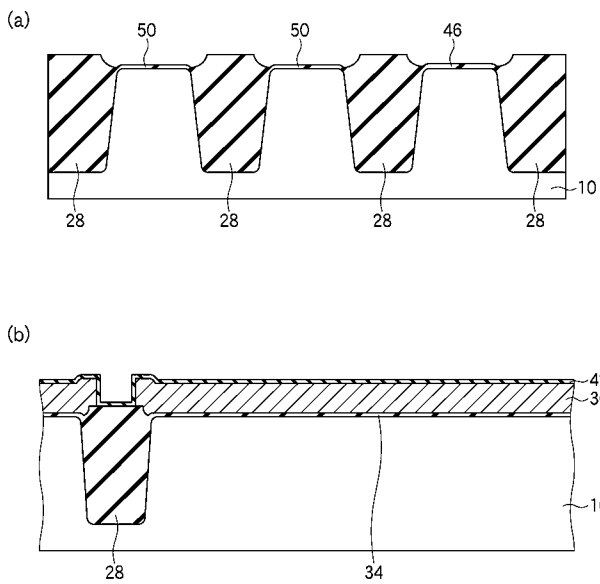
【 図 1 7 】



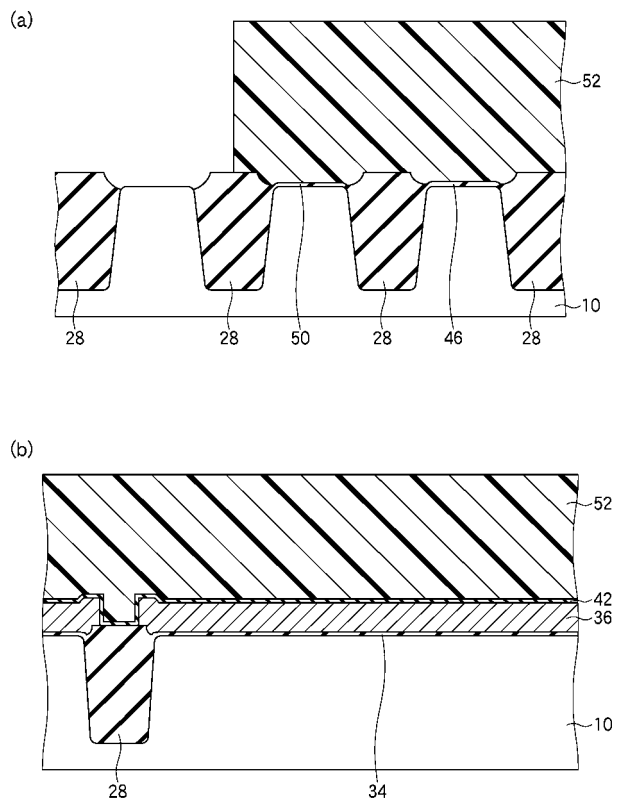
【 図 1 8 】



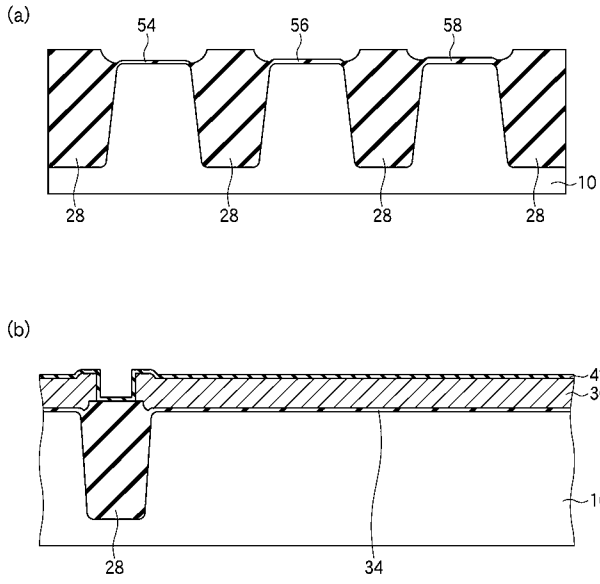
【 図 1 9 】



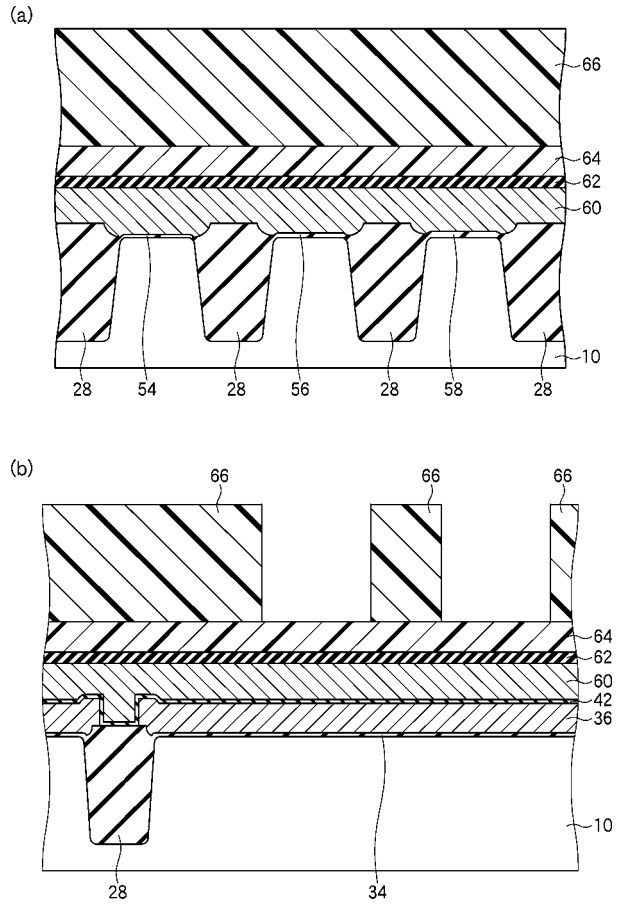
【 図 2 0 】



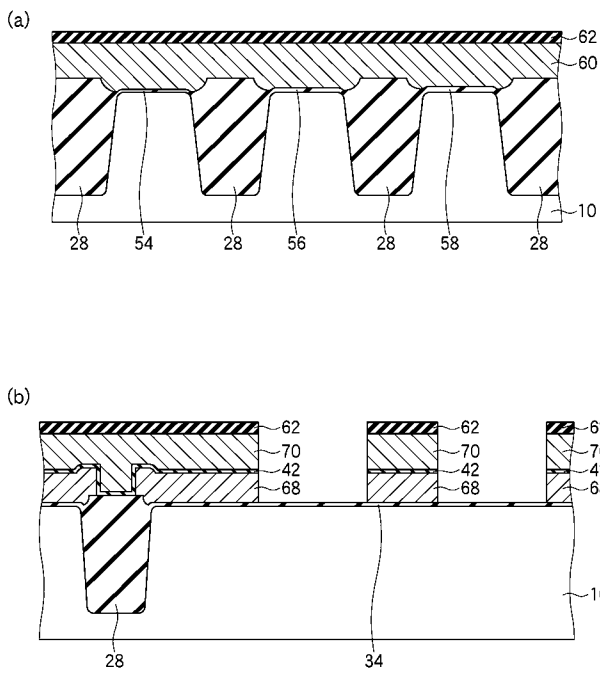
【 図 2 1 】



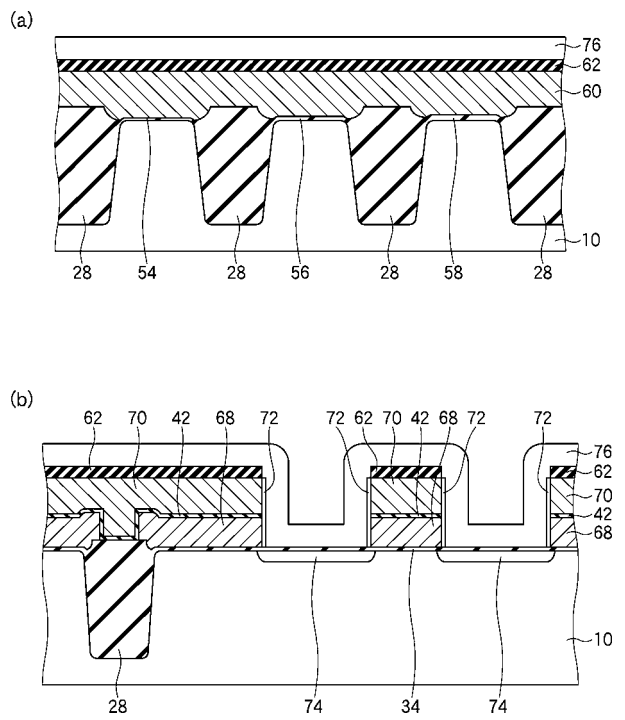
【 図 2 2 】



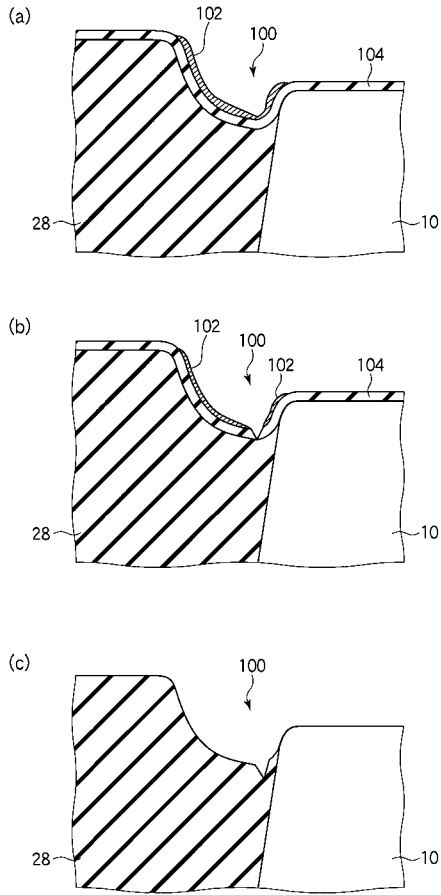
【 図 2 3 】



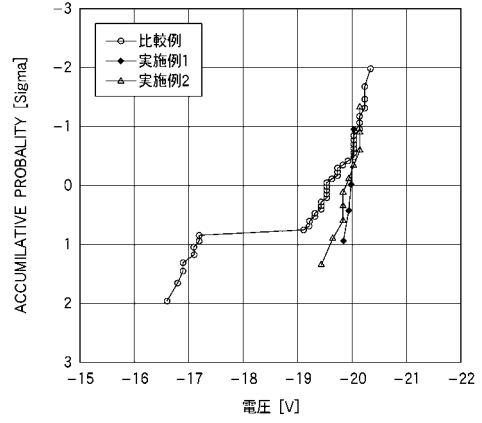
【 図 2 4 】



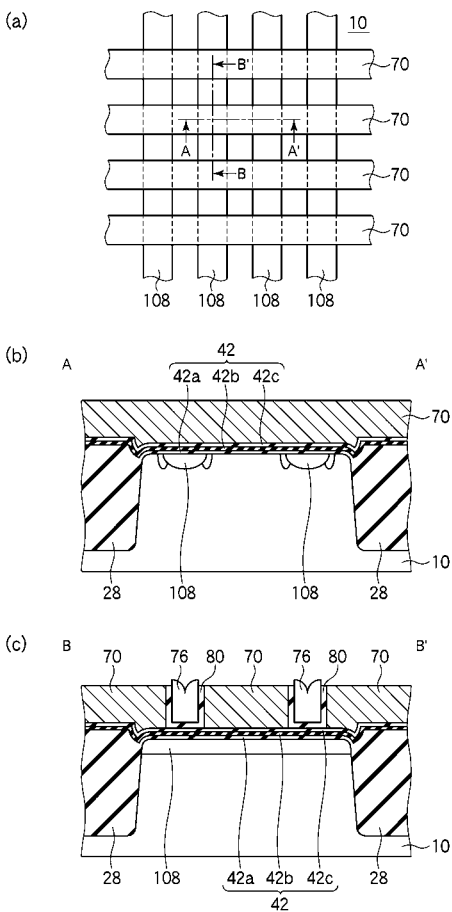
【 図 2 9 】



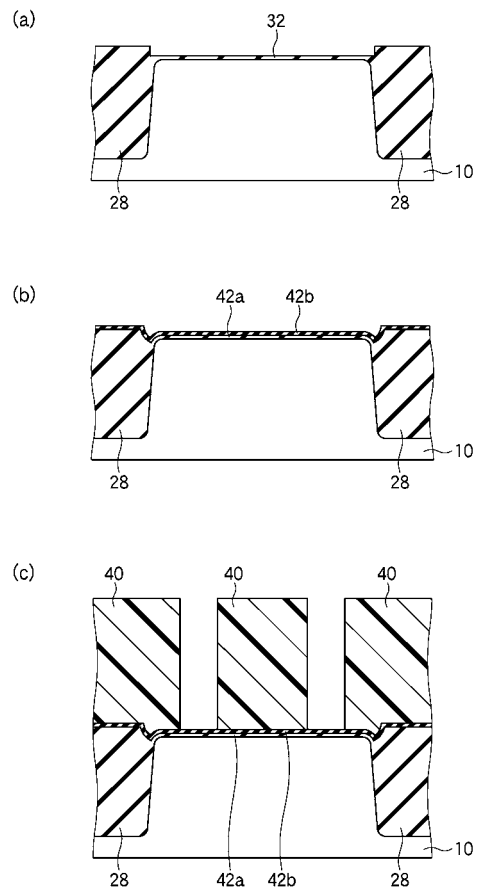
【 図 3 1 】



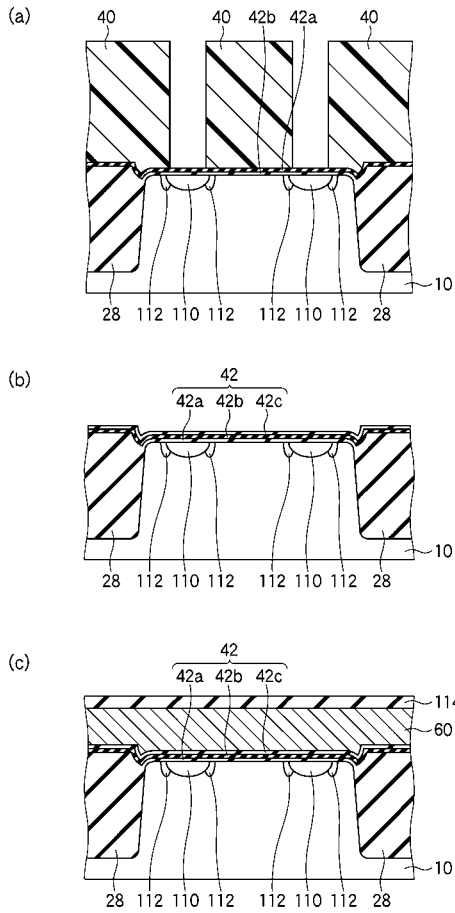
【 图 3 2 】



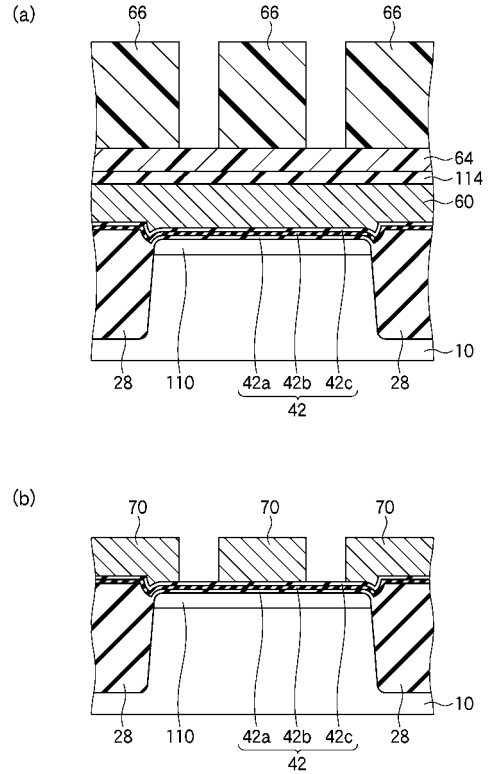
【 图 3 3 】



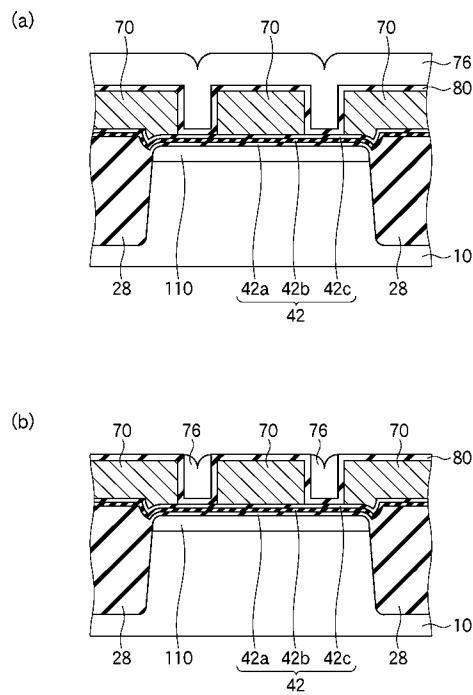
【 図 3 4 】



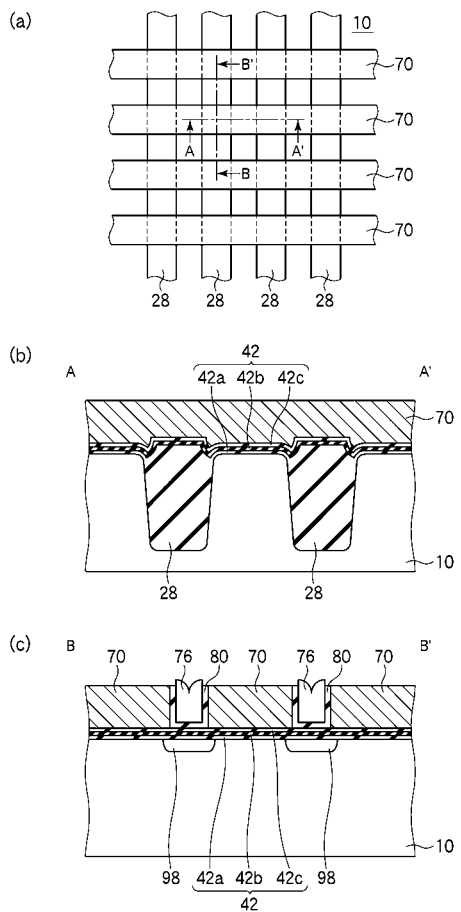
【 図 3 5 】



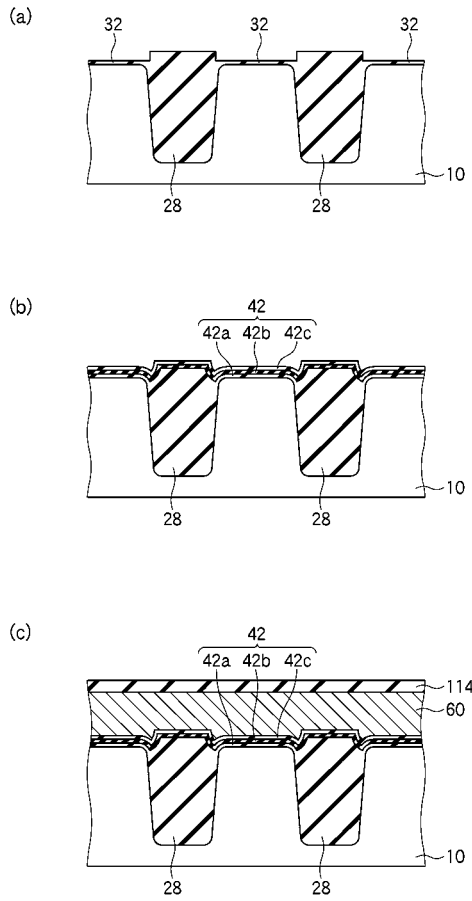
【 図 3 6 】



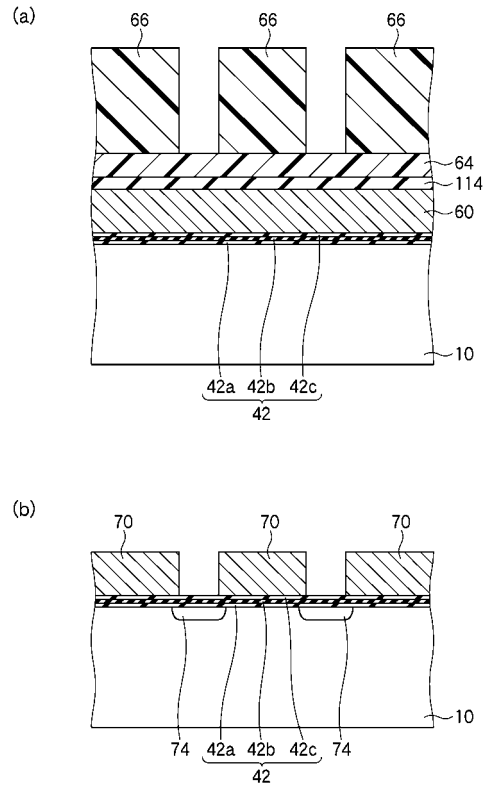
【 図 3 7 】



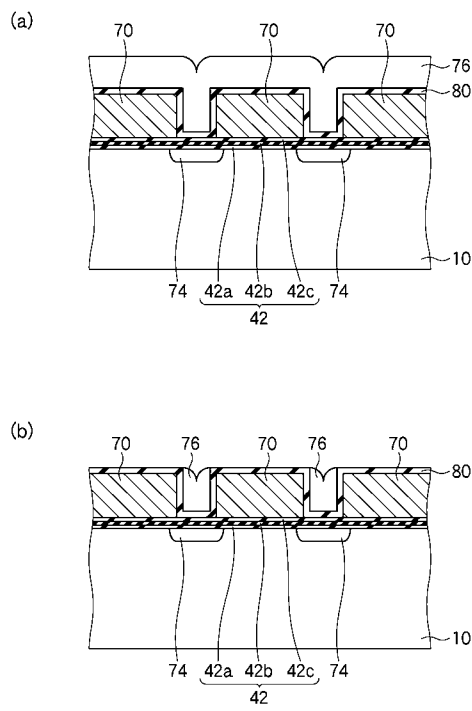
【 図 3 8 】



【 図 3 9 】

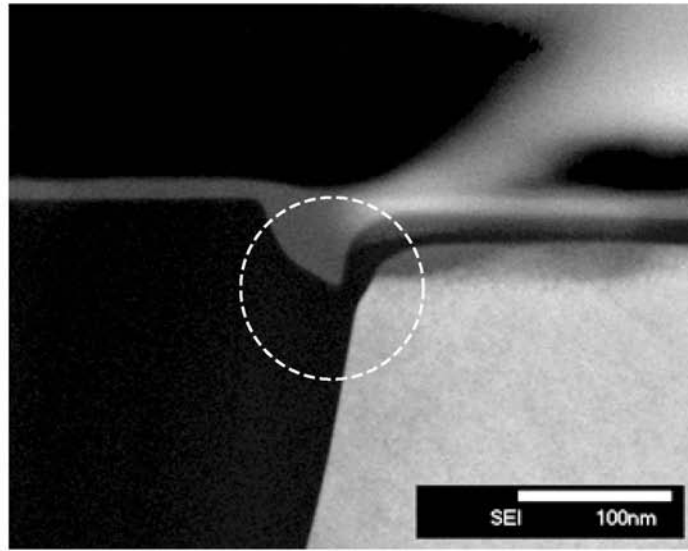


【 図 4 0 】

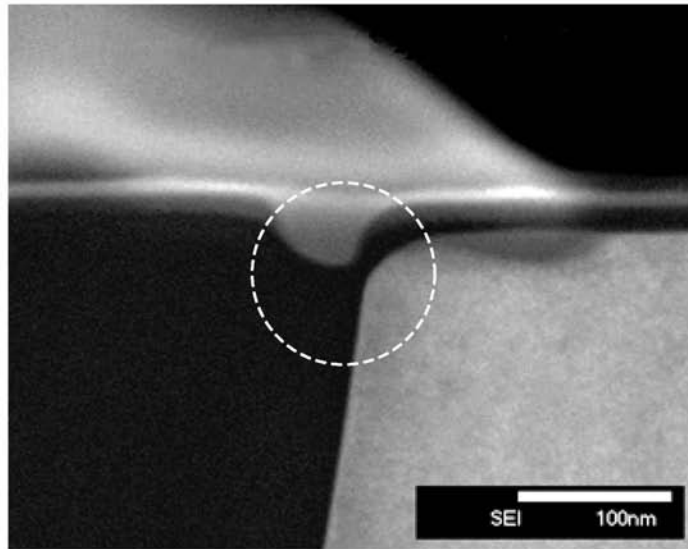


【 図 3 0 】

(a)



(b)



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード(参考)
H 0 1 L 21/76 (2006.01)

(72)発明者 姉崎 徹
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

(72)発明者 小川 裕之
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

(72)発明者 有吉 潤一
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 5F032 AA34 AA45 AA77 CA03 CA17 CA24 CA25 DA02 DA04 DA23
 DA24 DA25 DA28 DA33 DA43 DA53 DA74 DA78
 5F083 EP02 EP18 EP23 EP55 EP56 EP63 EP68 GA24 GA27 JA02
 JA04 JA33 NA01 NA06 PR03 PR05 PR09 PR40 PR43 PR45
 PR53 PR55 ZA07 ZA12 ZA13 ZA15
 5F101 BA29 BA36 BA45 BB05 BD07 BD27 BD35 BH14 BH21